

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2018-517298

(P2018-517298A)

(43) 公表日 平成30年6月28日(2018.6.28)

(51) Int.Cl.
H01L 33/62 (2010.01)F I
H01L 33/62テーマコード (参考)
5 F 1 4 2

審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 38 頁)

(21) 出願番号 特願2017-560320 (P2017-560320)
 (86) (22) 出願日 平成27年11月4日 (2015.11.4)
 (85) 翻訳文提出日 平成29年11月15日 (2017.11.15)
 (86) 国際出願番号 PCT/CN2015/093787
 (87) 国際公開番号 WO2017/075776
 (87) 国際公開日 平成29年5月11日 (2017.5.11)

(71) 出願人 517399181
 ゴルテック インコーポレイテッド
 中華人民共和国 261031 シャント
 ン、ウェイファン、ハイテク インダス
 トリー ディストリクト、ドンファン ロ
 ード 268
 (74) 代理人 110000408
 特許業務法人高橋・林アンドパートナーズ
 (72) 発明者
 ゾウ、クアンボ
 中華人民共和国 261031 シャント
 ン、ウェイファン、ハイテク インダス
 トリー ディストリクト、ドンファン ロ
 ード 268

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 マイクロ発光ダイオードの搬送方法、製造方法、装置及び電子機器

(57) 【要約】

【課題】本発明は、マイクロ発光ダイオードの搬送方法、製造方法、装置及び電子機器を開示する。

【解決手段】マイクロ発光ダイオードを搬送する該方法は、表面にマイクロ発光ダイオードが設けられたオリジナル基板であってレーザー光透過性を有するオリジナル基板の裏面にマスク層を形成することと、オリジナル基板におけるマイクロ発光ダイオードを受け基板に予め設置された接続パッドと接触させることと、オリジナル基板側からマスク層を介してレーザー光でオリジナル基板を照射することにより、オリジナル基板からマイクロ発光ダイオードを剥離することと、を含む。

【選択図】 図 1 9

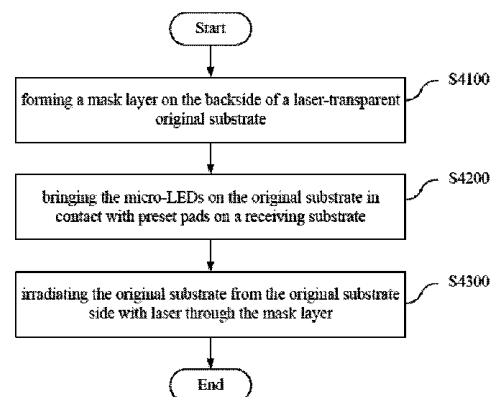


FIG. 19

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

表面にマイクロ発光ダイオードが設けられたオリジナル基板であってレーザー光透過性を有するオリジナル基板の裏面にマスク層を形成することと、

オリジナル基板におけるマイクロ発光ダイオードを受け基板に予め設置された接続パッドと接触させることと、

オリジナル基板側からマスク層を介してレーザー光でオリジナル基板を照射することにより、オリジナル基板からマイクロ発光ダイオードを剥離することと、

を含む、ことを特徴とするマイクロ発光ダイオードを搬送する方法。

【請求項 2】

オリジナル基板はサファイア基板であり、オリジナル基板の厚さ範囲は $20 \sim 1000 \mu\text{m}$ 、又は $50 \sim 500 \mu\text{m}$ 、又は $100 \sim 300 \mu\text{m}$ であることを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

前記マスク層の空間分解能の範囲は $1 \sim 50 \mu\text{m}$ であることを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】

前記マスク層の材料は、フォトレジスト、ポリマー、金属/金属化合物、金属/金属合金、金属/金属合成物、シリコン、シリサイドから選ばれることを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

【請求項 5】

前記マイクロ発光ダイオードは、マイクロバンプ接合を介して前記接続パッドと接触することを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

【請求項 6】

オリジナル基板からマイクロ発光ダイオードを剥離する時、前記マイクロ発光ダイオードに非接触の作用力を印加することを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

【請求項 7】

前記非接触の作用力は、重力、静電気力と電磁力の少なくとも 1 つであることを特徴とする請求項 6 に記載の方法。

【請求項 8】

前記レーザー光のレーザービームの寸法は $50 \sim 5000 \mu\text{m}$ であることを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

【請求項 9】

冗長方式で前記マイクロ発光ダイオードを受け基板に配置することを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

【請求項 10】

請求項 1 に記載の方法を使用してマイクロ発光ダイオードをマイクロ発光ダイオード装置の受け基板に搬送することを含む、マイクロ発光ダイオード装置を製造する方法。

【請求項 11】

請求項 10 に記載の方法を使用して製造されるマイクロ発光ダイオード装置。

【請求項 12】

請求項 11 に記載のマイクロ発光ダイオード装置を含む電子機器。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、表示に用いられるマイクロ発光ダイオードに関し、より具体的には、マイクロ発光ダイオードを搬送する方法、マイクロ発光ダイオード装置を製造する方法、マイクロ発光ダイオード装置及びマイクロ発光ダイオード装置を含む電子機器に関する。

【背景技術】**【0002】**

マイクロ発光ダイオード（Micro LED）技術は、マイクロサイズのLEDアレイを基板に高密度集積することである。現在、マイクロ発光ダイオード技術は発展し始め、産業界では、高品質マイクロ発光ダイオード製品の市場登場が期待されている。高品質マイクロ発光ダイオード製品は、既に市場に登場している例えばLCD/OLEDのような従来の表示製品に対し多大な影響を与える。

【0003】

マイクロ発光ダイオードの製造過程において、まずドナーウェハにマイクロ発光ダイオードを形成し、続いてマイクロ発光ダイオードを、例えばディスプレイである受け基板に搬送する。

【0004】

マイクロ発光ダイオードの製造過程における1つの難題は、如何にマイクロ発光ダイオードをドナーウェハから受け基板に搬送するかである。従来技術において、一般的に静電型ピックアップの方式により前記搬送を実行する。静電型ピックアップの過程には搬送ヘッドアレイを使用する必要がある。搬送ヘッドアレイは、その構造が比較的複雑であり、その信頼性を考慮しなければならない。搬送ヘッドアレイを製造するには余分なコストがかかる。搬送ヘッドアレイによるピックアップの前には位相変化を発生させる必要がある。また、搬送ヘッドアレイによる製造過程に、マイクロ発光ダイオードの位相変化に用いられるサーマルバジェットは制限され、一般的に350より小さく、又は、より具体的には、200より小さい。そうでなければ、マイクロ発光ダイオードの性能が劣化する。一般的に、搬送ヘッドアレイによる製造過程に2回搬送する必要がある、すなわち、ドナーウェハからキャリアウエハまでの搬送及びキャリアウエハから受け基板までの搬送が必要である。

【0005】

特許文献1は、マイクロデバイスを搬送するのに用いられる搬送ヘッドアレイを開示し、搬送ヘッドにおける電極に電圧を印加することによってマイクロデバイスをピックアップする。該特許は参考として本明細書に全て引用される。

【0006】

特許文献2は、マイクロ発光ダイオードアレイを形成する方法を開示し、搬送ヘッドを使用してマイクロ発光ダイオードアレイを受け基板に搬送する。該特許は参考として本明細書に全て引用される。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0007】

【特許文献1】米国特許US8,333,860 B1

【特許文献2】米国特許US8,426,227 B1

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

本発明の1つの目的はマイクロ発光ダイオードを搬送するのに用いられる新たな技術的解決手段を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0009】

本発明の一実施例によれば、表面（正面）にマイクロ発光ダイオードが設置されたオリジナル基板であってレーザー光透過性を有するオリジナル基板の裏面にマスク層を形成することと、オリジナル基板におけるマイクロ発光ダイオードを受け基板に予め設置された接続パッドと接触させることと、オリジナル基板側からマスク層を介してレーザー光でオリジナル基板を照射することにより、オリジナル基板からマイクロ発光ダイオードを剥離することを含む、マイクロ発光ダイオードを搬送する方法を提供する。

【0010】

好ましくは、オリジナル基板はサファイア基板であり、オリジナル基板の厚さ範囲は20

10

20

30

40

50

～ 1 0 0 0 μm 、又は 5 0 ～ 5 0 0 μm 、又は 1 0 0 ～ 3 0 0 μm である。

【 0 0 1 1 】

好ましくは、前記マスク層の空間分解能の範囲は 1 ～ 5 0 μm である。

【 0 0 1 2 】

好ましくは、前記マスク層の材料は、フォトレジスト、ポリマー、金属 / 金属化合物、金属 / 金属合金、金属 / 金属合成物、シリコン、シリサイドから選ばれる。

【 0 0 1 3 】

好ましくは、前記マイクロ発光ダイオードは、マイクロバンプ接合を介して前記接続パッドと接触する。

【 0 0 1 4 】

好ましくは、オリジナル基板からマイクロ発光ダイオードを剥離する時、前記マイクロ発光ダイオードに非接触の作用力を印加する。

【 0 0 1 5 】

好ましくは、前記非接触の作用力は、重力、静電気力と電磁力の少なくとも 1 つである。

【 0 0 1 6 】

好ましくは、前記レーザー光のレーザービームの寸法は 5 0 ～ 5 0 0 0 μm である。

【 0 0 1 7 】

好ましくは、前記非接触の作用力は、重力、静電気力と電磁力の少なくとも 1 つである。

【 0 0 1 8 】

好ましくは、冗長方式で前記マイクロ発光ダイオードを受け基板に配置する。

【 0 0 1 9 】

本発明の別の実施例によれば、本発明による方法を使用してマイクロ発光ダイオードをマイクロ発光ダイオード装置の受け基板に搬送することを含む、マイクロ発光ダイオード装置を製造する方法を提供する。

【 0 0 2 0 】

本発明の別の実施例によれば、本発明による方法を使用して製造されたマイクロ発光ダイオード装置を提供する。本発明の別の実施例によれば、本発明によるマイクロ発光ダイオード装置を含む電子機器を提供する。

【 0 0 2 1 】

また、当業者であれば、従来技術に多くの問題が存在するが、本発明の各実施例又は請求項の技術的解決手段は、1 つ又は複数の問題点のみを改善し、従来技術又は背景技術に挙げられた全ての技術的問題を同時に解決する必要がないことを理解すべきである。当業者であれば、1 つの請求項に言及されていない内容を該請求項を制限するものとしてはならないことを理解すべきである。

【 0 0 2 2 】

以下、本発明のその他の特徴及びその利点が明瞭であるように、図面を参照して本発明の例示的な実施例を詳細に説明する。

【図面の簡単な説明】

【 0 0 2 3 】

添付の図面は明細書に合わせられ明細書の一部となり、本発明の実施例を示し、その説明とともに本発明の原理を解釈するのに用いられる。

【図 1】本発明による方法の一例示的な実施例を示すフローチャートである。

【図 2 A】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる一実施例を示す。

【図 2 B】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる一実施例を示す。

【図 2 C】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる一実施例を示す。

【図 2 D】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる一実施例を示す。

【図 2 E】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる一実施例を示す。

【図 2 F】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる一実施例を示す。

【図 2 G】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる一実施例を示す。

【図 3】本発明による方法の別の例示的な実施例を示すフローチャートである。

10

20

30

40

50

- 【図 4 A】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる別の实例を示す。
- 【図 4 B】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる別の实例を示す。
- 【図 4 C】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる別の实例を示す。
- 【図 4 D】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる別の实例を示す。
- 【図 4 E】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる別の实例を示す。
- 【図 4 F】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる別の实例を示す。
- 【図 4 G】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる別の实例を示す。
- 【図 4 H】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる別の实例を示す。
- 【図 4 I】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる別の实例を示す。
- 【図 4 J】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる別の实例を示す。
- 【図 4 K】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる別の实例を示す。
- 【図 4 L】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる別の实例を示す。
- 【図 5】本発明による方法のまた別の例示的な実施例を示すフローチャートである。
- 【図 6 A】本発明による赤色マイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる实例を示す。
- 【図 6 B】本発明による赤色マイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる实例を示す。
- 【図 6 C】本発明による赤色マイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる实例を示す。
- 【図 6 D】本発明による赤色マイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる实例を示す。
- 【図 6 E】本発明による赤色マイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる实例を示す。
- 【図 6 F】本発明による赤色マイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる实例を示す。
- 【図 7 A】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられるまた別の实例を示す。
- 【図 7 B】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられるまた別の实例を示す。
- 【図 7 C】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられるまた別の实例を示す。
- 【図 7 D】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられるまた別の实例を示す。
- 【図 7 E】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられるまた別の实例を示す。
- 【図 7 F】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられるまた別の实例を示す。
- 【図 7 G】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられるまた別の实例を示す。
- 【図 7 H】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられるまた別の实例を示す。
- 【図 7 I】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられるまた別の实例を示す。
- 【図 7 J】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられるまた別の实例を示す。
- 【図 7 K】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられるまた別の实例を示す。
- 【図 7 L】本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられるまた別の实例を示す。
- 【図 8】本発明による横方向マイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる一实例を示す。
- 【図 9】本発明による横方向マイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる別の实例を示す。
- 【図 10】本発明による方法のまた別の例示的な実施例を示すフローチャートである。
- 【図 11】本発明による方法のまた別の例示的な実施例を示すフローチャートである。
- 【図 12 A】本発明によるマイクロ発光ダイオードの欠陥を修復するのに用いられる一实例を示す。

10

20

30

40

50

【図 1 2 B】本発明によるマイクロ発光ダイオードの欠陥を修復するのに用いられる一実例を示す。

【図 1 2 C】本発明によるマイクロ発光ダイオードの欠陥を修復するのに用いられる一実例を示す。

【図 1 2 D】本発明によるマイクロ発光ダイオードの欠陥を修復するのに用いられる一実例を示す。

【図 1 2 E】本発明によるマイクロ発光ダイオードの欠陥を修復するのに用いられる一実例を示す。

【図 1 2 F】本発明によるマイクロ発光ダイオードの欠陥を修復するのに用いられる一実例を示す。

10

【図 1 3】本発明による方法のまた別の例示的な実施例を示すフローチャートである。

【図 1 4 A】本発明による欠陥を有するマイクロ発光ダイオードを事前排除するのに用いられる一実例を示す。

【図 1 4 B】本発明による欠陥を有するマイクロ発光ダイオードを事前排除するのに用いられる一実例を示す。

【図 1 4 C】本発明による欠陥を有するマイクロ発光ダイオードを事前排除するのに用いられる一実例を示す。

【図 1 5 A】本発明による欠陥を有するマイクロ発光ダイオードを事前排除するのに用いられる別の実例を示す。

【図 1 5 B】本発明による欠陥を有するマイクロ発光ダイオードを事前排除するのに用いられる別の実例を示す。

20

【図 1 6 A】図 1 5 B においてブロック A により示された領域の拡大図である。

【図 1 6 B】図 1 5 B においてブロック A により示された領域の拡大図である。

【図 1 7】本発明による方法のまた別の例示的な実施例を示すフローチャートである。

【図 1 8 A】本発明によるウェハレベルでのマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる一実例を示す。

【図 1 8 B】本発明によるウェハレベルでのマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる一実例を示す。

【図 1 8 C】本発明によるウェハレベルでのマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる一実例を示す。

30

【図 1 8 D】本発明によるウェハレベルでのマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる一実例を示す。

【図 1 8 E】本発明によるウェハレベルでのマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる一実例を示す。

【図 1 8 F】本発明によるウェハレベルでのマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる一実例を示す。

【図 1 8 G】本発明によるウェハレベルでのマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる一実例を示す。

【図 1 8 H】本発明によるウェハレベルでのマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる一実例を示す。

40

【図 1 8 I】本発明によるウェハレベルでのマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる一実例を示す。

【図 1 8 J】本発明によるウェハレベルでのマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる一実例を示す。

【図 1 9】本発明による方法のまた別の例示的な実施例を示すフローチャートである。

【図 2 0 A】本発明によるマイクロ発光ダイオードを搬送するのに用いられるまた別の実例を示す。

【図 2 0 B】本発明によるマイクロ発光ダイオードを搬送するのに用いられるまた別の実例を示す。

【図 2 0 C】本発明によるマイクロ発光ダイオードを搬送するのに用いられるまた別の実

50

例を示す。

【図 20D】本発明によるマイクロ発光ダイオードを搬送するのに用いられるまた別の実例を示す。

【図 20E】本発明によるマイクロ発光ダイオードを搬送するのに用いられるまた別の実例を示す。

【図 20F】本発明によるマイクロ発光ダイオードを搬送するのに用いられるまた別の実例を示す。

【図 20G】本発明によるマイクロ発光ダイオードを搬送するのに用いられるまた別の実例を示す。

【図 20H】本発明によるマイクロ発光ダイオードを搬送するのに用いられるまた別の実例を示す。 10

【図 20I】本発明によるマイクロ発光ダイオードを搬送するのに用いられるまた別の実例を示す。

【発明を実施するための形態】

【0024】

以下、図面を参照して本発明の様々な例示的な実施例を詳細に説明する。注意すべきことは、別途具体的な説明がない限り、これらの実施例に記載の部品とステップの相対位置、数式及び数値は本発明の範囲を制限するものではない。

【0025】

以下、少なくとも 1 つの例示的な実施例に対する説明は実質的に解釈的なものに過ぎず、本発明及びその応用又は使用を制限するものではない。 20

【0026】

かかる分野における一般技術者の公知する技術、方法及び装置に対する詳細な説明は省略されるかも知れないが、適切な場合、前記技術、方法及び装置は明細書の一部と見なされるべきである。

【0027】

ここで例示し検討される全ての事例において、いかなる具体的な数値は例示的なものに過ぎず、制限するためのものではないと解釈されるべきである。そのため、例示的な実施例のその他の事例は異なる数値を有することができる。

【0028】

注意すべきことは、類似する符号とアルファベットは以下の図面において類似する項目を表示するため、ある項目が 1 つの図面に定義された場合、後の図面においてはさらに検討する必要がない。 30

【0029】

以下、図面を参照して本発明の実施例と実例を説明する。

【0030】

図 1 は本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる方法の一例示的な実施例を示すフローチャートである。

【0031】

図 1 に示すように、ステップ S 1100 において、レーザー光透過性を有するオリジナル基板にマイクロ発光ダイオードを形成する。 40

【0032】

前記レーザー光透過性を有するオリジナル基板は、例えば、サファイア基板、SiC 基板などであってもよい。前記マイクロ発光ダイオードは、ディスプレイパネルに取り付けられても良い。

【0033】

当業者であれば、オリジナル基板に 1 つのマイクロ発光ダイオードを形成してもよく、又は複数のマイクロ発光ダイオードを形成してもよいことを理解すべきである。例えば、レーザー光透過性を有するオリジナル基板に複数のマイクロ発光ダイオードを形成することができる。前記複数のマイクロ発光ダイオードはアレイを形成することができる。 50

【 0 0 3 4 】

一実例において、レーザー光透過性を有するオリジナル基板に複数のマイクロ発光ダイオードが形成される場合、オリジナル基板は更に複数の分割され、より柔軟に搬送されることができる。

【 0 0 3 5 】

ステップ S 1 2 0 0 において、マイクロ発光ダイオードを受け基板に予め設置された接続パッドと接触させる。

【 0 0 3 6 】

例えば、前記受け基板はディスプレイパネルである。

【 0 0 3 7 】

例えば、前記接続パッドは、ディスプレイに用いられる赤色画素アレイ、黄色画素アレイ又は青色画素アレイに設置されることができる。

【 0 0 3 8 】

一実例において、複数のマイクロ発光ダイオードが形成された場合、複数のマイクロ発光ダイオードの少なくとも1つのマイクロ発光ダイオードを受け基板に予め設置された少なくとも1つの接続パッドと接触させることができる。前記少なくとも1つのマイクロ発光ダイオードは、前記複数のマイクロ発光ダイオードのうちの1つ、複数又は全部であってもよい。当業者であれば、ここで、剥離される少なくとも1つのマイクロ発光ダイオードと接続パッドが接触することだけを説明したが、前記複数のマイクロ発光ダイオードのうちその他のマイクロ発光ダイオードも接続パッドと接触することができることを理解すべきである。

【 0 0 3 9 】

例えば、接触のステップにおいて、マイクロ発光ダイオードを液体フィルムを介して受け基板に予め設置された接続パッドと接触させることができる。例えば、前記液体フィルムは、フラックスを含むことができる。ここで、液体フィルム（フラックス）の表面張力によって、マイクロ発光ダイオードは剥離されやすくなり、且つ成功率も非常に高い。

【 0 0 4 0 】

ステップ S 1 3 0 0 において、オリジナル基板側からレーザー光でオリジナル基板を照射することにより、オリジナル基板からマイクロ発光ダイオードを剥離する。

【 0 0 4 1 】

一実例において、少なくとも1つのマイクロ発光ダイオードが接続パッドと接触する場合、オリジナル基板側からレーザー光でオリジナル基板における少なくとも1つの領域を照射することにより、オリジナル基板から前記少なくとも1つのマイクロ発光ダイオードを剥離することができる。例えば、前記少なくとも1つの領域を技術者により選択することができる。例えば、前記少なくとも1つの領域は、それぞれ前記少なくとも1つのマイクロ発光ダイオードに対応することができる。前記少なくとも1つの領域は、オリジナル基板における一部の領域のみであってもよく、又は全ての領域であってもよい。

【 0 0 4 2 】

別の実例において、更に前記オリジナル基板を移動することによって、別のマイクロ発光ダイオードを搬送することができる。

【 0 0 4 3 】

別の実例において、オリジナル基板を使用して搬送した後、ディスプレイパネルにおける一部のドットにマイクロ発光ダイオードが欠損する場合に対応するために、別のレーザー光透過性を有するスペア基板を使用することができる。例えば、別のスペア基板にマイクロ発光ダイオードを形成し、スペア基板におけるマイクロ発光ダイオードを受け基板に予め設置された接続パッド（欠損位置）と接触させ、スペア基板側からレーザー光でスペア基板を照射することにより、スペア基板からマイクロ発光ダイオードを剥離することができる。このような方式で、更にディスプレイの品質を向上させることができる。

【 0 0 4 4 】

マイクロ発光ダイオードを受け基板に搬送した後、受け基板にマイクロ発光ダイオードア

10

20

30

40

50

レイを形成することができる。

【0045】

マイクロ発光ダイオードを受け基板に搬送した後に、更に後続のステップを含むことができる。

【0046】

例えば、更に受け基板において、剥離されたマイクロ発光ダイオードに対するリフロー半田付けを行うことができる。更に、マイクロ発光ダイオードに負極を堆積させることができる。各色のマイクロ発光ダイオードが搬送された後にリフロー半田付けを行うことができる。これに代えて、全ての色のマイクロ発光ダイオードが搬送された後にリフロー半田付けを行ってもよい。

10

【0047】

また、更に半田付けされたマイクロ発光ダイオードに対するポリマー充填を行うことができる。例えば、更にテーパ状の誘電体堆積でポリマー充填を代替することができる。

【0048】

別の実施例において、本発明は、マイクロ発光ダイオード装置を製造する方法を更に含む。該製造方法は、本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる方法を使用してマイクロ発光ダイオードを受け基板に搬送することを含む。前記受け基板は、例えばディスプレイパネルである。前記マイクロ発光ダイオード装置は、例えばディスプレイ装置である。

【0049】

別の実施例において、本発明は、マイクロ発光ダイオード装置、例えばディスプレイ装置を更に含む。本発明によるマイクロ発光ダイオード装置を製造する方法を使用することで、前記マイクロ発光ダイオード装置を製造することができる。

20

【0050】

従来技術に対して、同じ条件において、本発明の技術的解決手段により製造されたマイクロ発光ダイオードは、より簡単で、確実であり高性能を維持することができ、その生産率も高く、コストも低い。

【0051】

別の実施例において、本発明は、電子機器を更に含む。該電子機器は本発明によるマイクロ発光ダイオード装置を含む。該電子機器は、例えば、携帯電話、タブレットPCなどであってもよい。

30

【0052】

本発明の技術的解決手段において、直接オリジナル基板にマイクロ発光ダイオードを形成し、レーザー光リフトオフの方式により受け基板に搬送する。本発明の技術的解決手段は従来技術において想到できなかったものである。

【0053】

また、本発明によれば、マイクロ発光ダイオードを選択的に搬送することができる。

【0054】

また、本発明の技術的解決手段において、1回のみの搬送を行うことができるが、従来技術においては2回の搬送を行う必要がある。

40

【0055】

また、従来技術に比べて、本発明の技術的解決手段は更に高効率で、コストがより低く、且つ、余分な熱消費による製品性能の劣化が発生しない。

【0056】

また、ピックアップヘッドを用いる従来技術に比べて、本発明は複雑なピックアップシステムの必要がないため、本発明により製造された製品は、コストがより低く、より信頼できる。

【0057】

また、従来技術におけるマイクロ発光ダイオードと中央部のキャリア基板との仮結合の必要がないため、本発明により、更にコストを削減することができる。

50

【 0 0 5 8 】

本発明ではピックアップヘッドを用いる従来技術において考慮しなければならない結合層の位相変化を考慮する必要がないため、本発明による製造方法は高い生産率を有することができ、余分な熱負荷の制限が小さい。そのため、同じ条件において、製造されたマイクロ発光ダイオードは更に高い性能を有する。

【 0 0 5 9 】

以下、図 2 A ~ 2 G を参照して本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる一実例を説明する。

【 0 0 6 0 】

図 2 A に示すように、例えばサファイア基板などのレーザー光透過性を有するオリジナル基板 1 にマイクロ発光ダイオード 2 を形成する。前記マイクロ発光ダイオード 2 は、例えば、垂直のマイクロ発光ダイオード構造を有する。マイクロ発光ダイオード 2 は、例えば、 n 型にドーピングされた GaN 層、複数の量子井戸構造、 p 型にドーピングされた GaN 層、 p 型金属電極及びマイクロポンプなどを含む。

10

【 0 0 6 1 】

図 2 A に示すように、複数のマイクロ発光ダイオード 2 を分割することができる。

【 0 0 6 2 】

図 2 B に示すように、オリジナル基板 1 を反転させ、液体フィルム（例えば、フラックスを含む）5 を有する受け基板 4 と一致するように合わせる。マイクロ発光ダイオード 2 におけるマイクロポンプはフラックスと接触する。受け基板 4 には接続パッド 3 が予め設置されている。例えば、接続パッド 3 は、赤色マイクロ発光ダイオードを受けるのに用いられる接続パッド 3 r、青色マイクロ発光ダイオードを受けるのに用いられる接続パッド 3 b と緑色マイクロ発光ダイオードを受けるのに用いられる接続パッド 3 g を含む。

20

【 0 0 6 3 】

図 2 C に示すように、レーザー光 6 でオリジナル基板における一部の領域 7 を選択的に照射することにより、形成された複数のマイクロ発光ダイオードから、選択されたマイクロ発光ダイオード 2 a、2 b をオリジナル基板から剥離する。

【 0 0 6 4 】

図 2 D に示すように、オリジナル基板 1 を持ち上げる。液体フィルムの表面張力の作用で、選択されたマイクロ発光ダイオード 2 a、2 b を簡単に剥離し、オリジナル基板 1 にその他のマイクロ発光ダイオードを残すことができる。

30

【 0 0 6 5 】

続いて、オリジナル基板を移動させ、図 2 C ~ 図 2 D の操作を繰り返すことにより、複数のマイクロ発光ダイオードを受け基板に搬送することができる。

【 0 0 6 6 】

図 2 E に示すように、複数のマイクロ発光ダイオードは受け基板 4 に搬送される。

【 0 0 6 7 】

図 2 F に示すように、例えば、リフロー半田付けを介して複数のマイクロ発光ダイオードを受け基板に半田付けする。その後、フラックスを洗浄することができる。

40

【 0 0 6 8 】

図 2 G に示すように、受け基板にポリマー 8 を充填し密閉する。その後、例えば、ITO 材料を利用して、 N 型金属電極 9 を堆積させる。

【 0 0 6 9 】

図 3 は本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる方法の別の例示的な実施例を示すフローチャートである。

【 0 0 7 0 】

図 3 に示すように、ステップ S 2 1 0 0 において、レーザー光透過性を有するオリジナル基板にマイクロ発光ダイオードを形成する。

【 0 0 7 1 】

ステップ S 2 2 0 0 において、受け基板に異方性導電層を設置する。

50

【0072】

例えば、異方性導電層は、異方性導電膜（ACF）、異方性導電ペースト（ACG）と異方性導電テープ（ACT）の少なくとも1つである。

【0073】

ステップS2300において、マイクロ発光ダイオードを受け基板における異方性導電層と接触させる。例えば、マイクロ発光ダイオードと受け基板における異方性導電層を接着させることができる。このステップにおいて、例えば、まずマイクロ発光ダイオードと受け基板における対応の接続パッドを位置合わせすることができる。

【0074】

ステップS2400において、オリジナル基板側からレーザー光でオリジナル基板を照射することにより、オリジナル基板からマイクロ発光ダイオードを剥離する。

10

【0075】

例えば、赤色発光ダイオード、緑色発光ダイオード、青色発光ダイオードに対してそれぞれ上記ステップを実行することができる。それぞれ3種類の発光ダイオードに対して上記搬送を実行することは、上記ステップに対する簡単な繰り返しと見なすことができるため、ここで、詳細な説明を省略する。上記ステップにおけるそれぞれが1つの解決手段において実行されたことがあれば、該解決手段は本発明の保護範囲に含まれる。

【0076】

ステップS2500において、異方性導電層を処理することにより、マイクロ発光ダイオード（電極）と受け基板における接続パッドを電氣的に接続させる。

20

【0077】

一実例において、補助基板を使用して、マイクロ発光ダイオード側から異方性導電層に圧力を印加することができる。例えば、異方性導電層を処理する温度は150～200であってもよい。例えば、印加される圧力は1MPa～4MPaである。例えば、圧力を印加する時間は10秒～30秒である。

【0078】

一実例において、補助基板は平板型のリジッド基板であってもよい。本願の発明者は、リジッド基板を用いることによってマイクロ発光ダイオードに発生可能な変位を減少させることができることを発見した。これは当業者にまだ注目されていないところである。

【0079】

例えば、補助基板の表面には仮結合のポリマーが塗布されることができる。この場合、ステップS2500は、さらに、仮結合のポリマーを介して補助基板を異方性導電層に結合させることと、圧力を印加した後、仮結合のポリマーを介して補助基板を結合解除させることによって、補助基板を除去することと、を含むことができる。補助基板をマイクロ発光ダイオードと仮結合させる利点は、マイクロ発光ダイオードの位置を相対的に固定し、異方性導電層を処理する期間におけるマイクロ発光ダイオードの変位を減少させることができることである。

30

【0080】

上記処理の後、マイクロ発光ダイオードに対し通常の後続処理を実行することができる。例えば、後続処理は、仮結合のポリマーをエッチングすることによって、マイクロ発光ダイオードのエピタキシャル層を露出させることと、マイクロ発光ダイオードのエピタキシャル層にN電極を形成することと、N電極においてパッケージングを行うことと、を含むことができる。

40

【0081】

例えば、受け基板は表示基板であってもよい。受け基板には、マイクロ発光ダイオードに電氣的に接続させるために、リード線及び接続パッドを予め設置することができる。

【0082】

この実施例において、異方性導電層によりマイクロ発光ダイオードと受け基板を接続させる。このような処理は比較的簡単であり、大量生産により適切である。

【0083】

50

該別の実施例において、本発明は、マイクロ発光ダイオード装置を製造する方法を更に含む。該製造方法は、本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる方法を使用してマイクロ発光ダイオードを受け基板に搬送することを含む。前記受け基板は、例えば、ディスプレイパネル又は表示基板である。前記マイクロ発光ダイオード装置は、例えば、ディスプレイ装置である。

【0084】

該別の実施例において、本発明は、マイクロ発光ダイオード装置、例えば、ディスプレイ装置を更に含む。前記実施例によるマイクロ発光ダイオード装置を製造する方法を使用して前記マイクロ発光ダイオード装置を製造することができる。前記実施例によるマイクロ発光ダイオード装置において、マイクロ発光ダイオードは、異方性導電層を介して受け基板における接続パッドと電氣的に接触するが、これは従来技術におけるマイクロ発光ダイオード装置と異なる。

10

【0085】

該別の実施例において、本発明は、電子機器を更に含む。該電子機器は、前記実施例によるマイクロ発光ダイオード装置を含む。該電子機器は、例えば、携帯電話、タブレットPCなどであってもよい。

【0086】

図4A～図4Lは本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる別の実例を示す。

【0087】

図4Aに示すように、例えばサファイア基板などのオリジナル基板201には赤色マイクロ発光ダイオード202がある。例えば表示基板などの受け基板204には異方性導電膜(ACF)203がある。受け基板204はマイクロ発光ダイオードを接続するための信号リード線205及び接続パッド205'を有する。

20

【0088】

図4Bに示すように、小さい力でオリジナル基板201(赤色マイクロ発光ダイオード202)を異方性導電膜203と接触させる。例えば、搬送しようとする赤色マイクロ発光ダイオード202を受け基板204における接続パッドと位置合わせすることができる。レーザー光206でオリジナル基板201を照射することにより、赤色マイクロ発光ダイオードを選択的に剥離する。

30

【0089】

図4Cには剥離後の赤色マイクロ発光ダイオード202rが示されている。

【0090】

図4Dはオリジナル基板207及びその緑色マイクロ発光ダイオード208を示す。剥離しようとする緑色マイクロ発光ダイオードは受け基板204における接続パッドと位置合わせられている。

【0091】

図4Eは、緑色マイクロ発光ダイオード208が小さい力により異方性導電膜203と接触することを示す。レーザー光209を介して少なくとも1つの緑色マイクロ発光ダイオードを選択的に剥離する。

40

【0092】

図4Fは剥離後の赤色マイクロ発光ダイオード202rと緑色マイクロ発光ダイオード208gを示す。

【0093】

図4Gはオリジナル基板210及びその青色マイクロ発光ダイオード211を示す。剥離しようとする青色マイクロ発光ダイオードは受け基板204における接続パッドと位置合わせられている。

【0094】

図4Hは、青色マイクロ発光ダイオード211が小さい力により異方性導電膜203と接触することを示す。レーザー光212を介して少なくとも1つの青色マイクロ発光ダイオ

50

ードを選択的に剥離する。

【0095】

図4 Iは剥離後の赤色マイクロ発光ダイオード202r、緑色マイクロ発光ダイオード208gと青色マイクロ発光ダイオード211bを示す。

【0096】

3色の発光ダイオードを搬送した後、欠陥が存在するか否かを点検し、修復することができる。

【0097】

図4 Jには補助基板213が示されている。補助基板213は平板型のリジッド基板、例えば、ガラス基板である。補助基板213には、ポリマー214、例えば、3M L C 5 200 / 5320ポリマーが塗布されている。該ポリマーは、例えば紫外線により硬化されることができ、且つ赤色レーザー光により結合解除されることができ。

【0098】

図4 Kにおいて、補助基板213を介してA C F 203に対する処理を行う。例えば、処理条件は、温度が150 ~ 200、印加される圧力が1 M P a ~ 4 M P a、圧力を印加する時間が10秒~30秒である。前記処理により、A C F 203は垂直方向にマイクロ発光ダイオードに対応する接続パッドと接続させる。

【0099】

その後、(ポリマー214を介して)補助基板213に対する結合解除を行う。

【0100】

図4 Lにおいて、下記のような通常の後続処理を実行する。ポリマー214をエッチングすることによって、マイクロ発光ダイオードのエピタキシャル層を露出させ、マイクロ発光ダイオードのエピタキシャル層にN電極215(例えば、ITO材料電極)を形成し、N電極においてパッケージング216(例えば、PET積層を行う)を行う。

【0101】

図5は本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる方法のもう一つの例示的な実施例を示すフローチャートである。

【0102】

図5に示すように、ステップS3100において、少なくとも1つのマイクロ発光ダイオードをオリジナル基板から支持体に搬送する。例えば、オリジナル基板はレーザー光透明性を有する。

【0103】

一例において、該ステップは、マイクロ発光ダイオードが形成されているオリジナル基板を、表面に光放出接着剤がある支持体に取り付けることと、オリジナル基板側からレーザー光でオリジナル基板を照射して、オリジナル基板から前記少なくとも1つのマイクロ発光ダイオードを剥離することと、支持体側から光を照射することにより、剥離されていないマイクロ発光ダイオードを放出する(離脱させる)ことを含むことができ、前記マイクロ発光ダイオードは光放出接着剤を介して支持体に接着される。この実施例において、支持体は透光性を有する。

【0104】

例えば、前記光放出接着剤は紫外線照射テープ(U V T a p e)であってもよい。例えば、支持体は剛性のものである。搬送過程に、マイクロ発光ダイオードの変位は最終的製品の品質に影響を与える。本願の発明者は、剛性の支持体を用いることによって、このような変位を減少させることを発見した。これは当業者にまだ注目されていないところである。例えば、支持体の材料はPETであってもよい。

【0105】

一般的に、赤色マイクロ発光ダイオードは、例えばサファイア基板などのレーザー光透明性の基板に形成されにくい。そのため、一実施例において、予め赤色マイクロ発光ダイオードを形成し、その後赤色マイクロ発光ダイオードをオリジナル基板に搬送することによって、最終的に受け基板に搬送することができる。例えば、該実施例において、成長基板に

10

20

30

40

50

赤色マイクロ発光ダイオードを形成することができる。続いて、赤色マイクロ発光ダイオードを中間基板に搬送する。その後、赤色マイクロ発光ダイオードを中間基板からオリジナル基板に搬送する。

【0106】

ステップS3200において、前記少なくとも1つのマイクロ発光ダイオードを支持体からスペア基板に搬送する。

【0107】

例えば、スペア基板はその表面にエラストマー又はポリマーを有する。例えば、エラストマー又はポリマーを介して前記少なくとも1つのマイクロ発光ダイオードをスペア基板に結合させる。

10

【0108】

一実施例において、該ステップは、さらに、前記少なくとも1つのマイクロ発光ダイオードを有する支持体をスペア基板に結合させることと、支持体側から光を照射して、前記少なくとも1つのマイクロ発光ダイオードを放出することと、を含むことができる。

【0109】

ステップS3300において、前記少なくとも1つのマイクロ発光ダイオードをスペア基板から受け基板に搬送する。

【0110】

一実施例において、該ステップは、さらに、前記少なくとも1つのマイクロ発光ダイオードと受け基板における接続パッドを位置合わせすることと、エラストマー又はポリマーを介して前記少なくとも1つのマイクロ発光ダイオードを剥離することとを含むことができる。

20

【0111】

例えば、それぞれ赤色マイクロ発光ダイオード、青色マイクロ発光ダイオードと緑色マイクロ発光ダイオードに対して上記搬送ステップを実行することができる。ここで、詳細な説明を省略する。

【0112】

上記処理の後、マイクロ発光ダイオードに対して通常の後続処理を実行することができる。例えば、後続処理は、マイクロ発光ダイオードを有する受け基板にポリマーを塗布することと、ポリマーを硬化させることと、ポリマーをエッチングすることによって、マイクロ発光ダイオードのエピタキシャル層を露出させることと、マイクロ発光ダイオードのエピタキシャル層にN電極を形成することと、N電極においてパッケージングを行うことと、を含むことができる。

30

【0113】

本発明の発明者は、マイクロ発光ダイオードの搬送過程に、一般的にオリジナル基板における一部のマイクロ発光ダイオードのみを搬送することを発見した。直接マイクロ発光ダイオードを受け基板に搬送する場合、オリジナル基板に残されたマイクロ発光ダイオードを汚染させやすい。この実施例において、中間を経由する支持体の搬送により、このような汚染を減少させることができる。

【0114】

該もう一つの実施例において、本発明は、さらに、マイクロ発光ダイオード装置を製造する方法を含む。該製造方法は、前記実施例によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる方法を使用してマイクロ発光ダイオードを受け基板に搬送することを含む。前記受け基板は、例えば、ディスプレイパネル又は表示基板である。前記マイクロ発光ダイオード装置は、例えば、ディスプレイ装置である。

40

【0115】

該また別の実施例において、本発明は、マイクロ発光ダイオード装置、例えば、ディスプレイ装置を更に含む。前記実施例によるマイクロ発光ダイオード装置を製造する方法を利用することで前記マイクロ発光ダイオード装置を製造することができる。

【0116】

50

一般的に、赤色マイクロ発光ダイオードは、例えばサファイア基板などのレーザー光透過性を有するオリジナル基板に直接形成されることができない。そのため、予め別の基板に赤色マイクロ発光ダイオードを形成し、その後、サファイア基板に搬送しなければならない。図6A～図6は本発明による赤色マイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる実例を示す。

【0117】

図6Aに示すように、例えばGaAs基板などの成長基板301に赤色マイクロ発光ダイオード302を形成する。

【0118】

図6Bに示すように、仮結合のポリマー303により、赤色マイクロ発光ダイオード302と例えばシリコン基板などの中間基板304を結合させる。ポリマー303は、例えば、熱剥離テープ（TRT）である。

【0119】

図6Cに示すように、例えば、湿式エッチングにより成長基板301を除去する。

【0120】

図6Dに示すように、例えばサファイア基板などのオリジナル基板306にフォトリジスト305が塗布されている。フォトリジスト305により、オリジナル基板306は赤色マイクロ発光ダイオード302に結合される。フォトリジスト305は、200以上の温度に耐えられるが、一般的には250以上である。

【0121】

図6Eに示すように、200より小さい温度で、ポリマー303を処理して、中間基板304を除去する。

【0122】

図6Fに示すように、各赤色マイクロ発光ダイオード302を隔離するために、フォトリジスト305に対するO₂プラズマエッチングを実行する。

【0123】

図7A～図7Lは、本発明によるマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられるまた別の実例を示す。

【0124】

図7Aに示すように、オリジナル基板406にはフォトリジスト405と赤色マイクロ発光ダイオード402がある。赤色マイクロ発光ダイオード402は紫外線照射テープ411に取り付けられている。紫外線照射テープ411は、剛性のPET支持体412に位置する。レーザー光413により、赤色マイクロ発光ダイオードを選択的に剥離する。

【0125】

図7Bに示すように、支持体412側から紫外線を照射することにより、剥離されていない赤色マイクロ発光ダイオードを放出する。

【0126】

剥離された赤色マイクロ発光ダイオード402rは、オリジナル基板406から離脱されやすい。図7Cに示すように、剥離された赤色マイクロ発光ダイオード402rは、紫外線照射テープ411に接着され、その他の赤色マイクロ発光ダイオードは依然としてオリジナル基板406に残される。

【0127】

図7Dに示すように、例えばガラス基板などのスペア基板415にはエラストマー/ポリマー416がある。例えば、スピンコートによりエラストマー/ポリマー416をスペア基板415に塗布することができる。エラストマー/ポリマー416は、例えばPDMS又は3MLC5320であってもよく、且つ、例えば紫外線により硬化されることができる。

【0128】

図7Eに示すように、支持体側から紫外線を完全に照射することにより、赤色マイクロ発光ダイオード及びエラストマー/ポリマー416を放出する。

10

20

30

40

50

【 0 1 2 9 】

その後、例えば、マイクロ発光ダイオードにはマイクロバンプがない場合、銀ペーストを利用してスペア基板 4 1 5 におけるマイクロ発光ダイオードをシルクスクリーン印刷することができる。

【 0 1 3 0 】

図 7 F に示すように、スペア基板 4 1 5 における赤色マイクロ発光ダイオード 4 0 2 r と受け基板 4 1 7 における接続パッド 4 1 9 を位置合わせする。例えば、受け基板 4 1 7 は表示基板であり、信号リード線 4 1 8 を含む。例えば、リフローにより、赤色マイクロ発光ダイオード 4 0 2 r を接続パッド 4 1 9 に結合させる。リフローの温度は、例えば 2 6 0 0 より高くてもよい。その後、レーザー光リフトオフにより、スペア基板 4 1 5 と受け基板 4 1 7 を分離する。

10

【 0 1 3 1 】

図 7 G は分離後の受け基板 4 1 7 を示す。受け基板 4 1 7 には接続パッド 4 1 9 と赤色マイクロ発光ダイオード 4 0 2 r がある。

【 0 1 3 2 】

図 7 H はスペア基板 4 2 0 から受け基板 4 1 7 に緑色マイクロ発光ダイオード 4 2 2 g を搬送することを示す図である。スペア基板 4 2 0 はエラストマー / ポリマー 4 2 1 を有する。

【 0 1 3 3 】

図 7 I は分離後の受け基板 4 1 7 を示す。受け基板 4 1 7 には接続パッド 4 1 9 、赤色マイクロ発光ダイオード 4 0 2 r 及び緑色マイクロ発光ダイオード 4 2 2 g がある。

20

【 0 1 3 4 】

図 7 J は、スペア基板 4 2 3 から受け基板 4 1 7 に青色マイクロ発光ダイオード 4 2 5 b を搬送することを示す図である。スペア基板 4 2 3 はエラストマー / ポリマー 4 2 4 を有する。

【 0 1 3 5 】

図 7 K は、分離後の受け基板 4 1 7 を示す。受け基板 4 1 7 には接続パッド 4 1 9 、赤色マイクロ発光ダイオード 4 0 2 r 、緑色マイクロ発光ダイオード 4 2 2 g 及び青色マイクロ発光ダイオード 4 2 5 b がある。

【 0 1 3 6 】

図 7 L において、搬送後のマイクロ発光ダイオードに対して下記のような通常の後続処理を実行する。マイクロ発光ダイオードを有する受け基板にポリマー 4 2 6 を塗布し、ポリマー 4 2 6 を硬化させ、ポリマーをエッチングすることによって、マイクロ発光ダイオードのエピタキシャル層を露出させ、マイクロ発光ダイオードのエピタキシャル層に N 電極 4 2 7 を形成し、N 電極においてパッケージング（図示せず）を行う。

30

【 0 1 3 7 】

本発明の技術的解決手段は、垂直構造のマイクロ発光ダイオードだけでなく、横方向構造のマイクロ発光ダイオード（フリップマイクロ発光ダイオード）を使用することもできる。上記図面に示された垂直構造のマイクロ発光ダイオードは例示的なものに過ぎず、本発明の範囲を限定するものではない。図 8 は横方向マイクロ発光ダイオードの実例を示す。

40

【 0 1 3 8 】

図 8 に示す実例において、マイクロ発光ダイオードは横方向マイクロ発光ダイオードである。横方向マイクロ発光ダイオードにおいて、P 電極と N 電極は同一側に位置する。図 8 は赤色横方向マイクロ発光ダイオード 5 0 5 、緑色横方向マイクロ発光ダイオード 5 0 6 と青色横方向マイクロ発光ダイオード 5 0 7 を示す。横方向マイクロ発光ダイオード 5 0 5 は、P 電極 5 0 5 p（正極）と N 電極 5 0 5 n（負極）を含む。横方向マイクロ発光ダイオード 5 0 6 は、P 電極 5 0 6 p と N 電極 5 0 6 n を含む。横方向マイクロ発光ダイオード 5 0 7 は、P 電極 5 0 7 p と N 電極 5 0 7 n を含む。

【 0 1 3 9 】

基板 5 0 4 にはリード線構造（接続パッドを含む）5 1 5 p、5 1 5 n、5 1 6 p、5 1

50

6 n、5 1 7 p、5 1 7 n が設置されている。リード線構造 5 1 5 p、5 1 6 p、5 1 7 p は、正極に接続される。リード線構造 5 1 5 n、5 1 6 n、5 1 7 n は、負極に接続される。

【0 1 4 0】

図 8 の実例において、横方向マイクロ発光ダイオードの電極 5 0 5 p、5 0 5 n、5 0 6 p、5 0 6 n、5 0 7 p、5 0 7 n は、それぞれ異方性導電層 5 0 3 を介してリード線構造 5 1 5 p、5 1 5 n、5 1 6 p、5 1 6 n、5 1 7 p、5 1 7 n に接続される。

【0 1 4 1】

横方向マイクロ発光ダイオードの間にポリマー 5 0 2 を塗布することができる。更に横方向マイクロ発光ダイオードに透明なカバー層 5 0 1 を設置することができる。

10

【0 1 4 2】

図 9 は横方向マイクロ発光ダイオードの別の実例を示す。図 9 の実例と図 8 の実例の相違点は、図 9 において、横方向マイクロ発光ダイオードが半田（異方性導電層ではなく）を介して基板に接続されることである。

【0 1 4 3】

図 9 には赤色横方向マイクロ発光ダイオード 6 0 5、緑色横方向マイクロ発光ダイオード 6 0 6 と青色横方向マイクロ発光ダイオード 6 0 7 が示されている。横方向マイクロ発光ダイオード 6 0 5 は、P 電極 6 0 5 p と N 電極 6 0 5 n を含む。横方向マイクロ発光ダイオード 6 0 6 は、P 電極 6 0 6 p と N 電極 6 0 6 n を含む。横方向マイクロ発光ダイオード 6 0 7 は、P 電極 6 0 7 p と N 電極 6 0 7 n を含む。

20

【0 1 4 4】

基板 6 0 4 にはリード線構造（接続パッドを含む）6 1 5 p、6 1 5 n、6 1 6 p、6 1 6 n、6 1 7 p、6 1 7 n が設置されている。リード線構造 6 1 5 p、6 1 6 p、6 1 7 p は正極に接続される。リード線構造 6 1 5 n、6 1 6 n、6 1 7 n は負極に接続される。

【0 1 4 5】

図 9 の実例において、例えば、横方向マイクロ発光ダイオードの電極 6 0 5 p、6 0 5 n、6 0 6 p、6 0 6 n、6 0 7 p、6 0 7 n は、半田突起 6 0 2 を含む。例えば、更に半田突起 6 0 2 にフラックスを塗布することができる。電極 6 0 5 p、6 0 5 n、6 0 6 p、6 0 6 n、6 0 7 p、6 0 7 n は、それぞれリード線構造 6 1 5 p、6 1 5 n、6 1 6 p、6 1 6 n、6 1 7 p、6 1 7 n（例えば、リフロー半田付けにより）に接合される。

30

【0 1 4 6】

例えば、更に横方向マイクロ発光ダイオードと基板 6 0 4 の間にポリマー 6 0 3 を充填することができる。更に、横方向マイクロ発光ダイオードに透明なカバー層 6 0 1 を設置することができる。これらの処理は従来技術から公知されているものであるため、ここで、その詳細な説明を省略する。

【0 1 4 7】

従って、例えば、本発明は、更に横方向マイクロ発光ダイオードの具体的な応用を含むことができる。具体的に、本発明は、更にマイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる方法を提供することができる。該方法は、レーザー光透過性を有するオリジナル基板に、P 電極と N 電極が同じ側に位置する横方向マイクロ発光ダイオードであるマイクロ発光ダイオードを形成することと、横方向マイクロ発光ダイオードの P 電極と N 電極を受け基板に予め設置された接続パッドと接触させることと、オリジナル基板側からレーザー光でオリジナル基板を照射することにより、オリジナル基板から横方向マイクロ発光ダイオードを剥離することと、を含む。

40

【0 1 4 8】

横方向マイクロ発光ダイオードを用いる効果は、マイクロ発光ダイオードが搬送された後の N 型金属電極処理を省略することができることである。更に、ウェハレベルでテストを行う時に P 電極と N 電極はいずれも既に形成されているため、ウェハレベルでの色分け及び / 又はテストを簡略化することができる。

50

【0149】

更に、例えば、この方法において、更に受け基板に異方性導電層を設置することにより、異方性導電層を通じて横方向マイクロ発光ダイオードのP電極とN電極を接続パッドと接触させることができる。続いて、オリジナル基板から横方向マイクロ発光ダイオードを剥離した後、異方性導電層を処理し、横方向マイクロ発光ダイオードのP電極とN電極を受け基板における接続パッドに電氣的に接続させる。

【0150】

例えば、異方性導電層は、異方性導電膜、異方性導電ペースト及び異方性導電テープの少なくとも1つであってもよい。

【0151】

異方性導電層の接着性及び液体（例えば、フラックス）の表面張力を利用して横方向マイクロ発光ダイオードのP電極とN電極を受け基板に予め設置された接続パッドと接触させる以外、本発明は、更に重力、静電気力及び/又は電磁力の作用を利用することで前記接触を実現することができる。

【0152】

例えば、オリジナル基板側からレーザー光でオリジナル基板を照射する場合、横方向マイクロ発光ダイオードはオリジナル基板から分離され、重力により、横方向マイクロ発光ダイオードは受け基板に落下する。

【0153】

例えば、前記接続パッドに電圧を印加することによって静電気力を印加することができ、それにより静電気力の作用を利用して、横方向マイクロ発光ダイオードをオリジナル基板から剥離させた後、受け基板に残す。

【0154】

例えば、横方向マイクロ発光ダイオードに磁気材料（例えばNi）が含まれている場合、磁場を設置し、電磁力の作用を利用して、横方向マイクロ発光ダイオードをオリジナル基板から剥離させた後、受け基板に残すことができる。

【0155】

同様に、更に、この横方向マイクロ発光ダイオードを応用した実例における搬送方法をマイクロ発光ダイオード装置を製造する方法に応用することによって、横方向マイクロ発光ダイオードを受け基板に搬送することができる。前記受け基板は、例えば、ディスプレイパネル又は表示基板である。前記マイクロ発光ダイオード装置は、例えば、ディスプレイ装置である。

【0156】

例えば、更に、前記製造方法を使用することでマイクロ発光ダイオード装置、例えば、ディスプレイ装置を製造することができる。このようなマイクロ発光ダイオード装置は横方向マイクロ発光ダイオードを用いる。

【0157】

例えば、本発明は、電子機器を更に含む。該電子機器は、前記マイクロ発光ダイオード装置を含む。該電子機器は、例えば、携帯電話、タブレットPCなどであってもよい。

【0158】

図10は本発明による非接触の作用力を利用してマイクロ発光ダイオードを搬送する方法を示すフローチャートである。

【0159】

図10に示すように、マイクロ発光ダイオードの搬送に用いられる方法では、ステップS4100において、レーザー光透過性を有するオリジナル基板にマイクロ発光ダイオードを形成する。

【0160】

前記マイクロ発光ダイオードは、例えば、横方向マイクロ発光ダイオードであってもよく、垂直構造のマイクロ発光ダイオードであってもよい。横方向マイクロ発光ダイオードにおいて、P電極とN電極は同じ側に位置する。垂直構造のマイクロ発光ダイオードにおい

10

20

30

40

50

て、P電極とN電極は反対側に位置する。

【0161】

ステップS4200において、オリジナル基板側からレーザー光でオリジナル基板を照射することにより、オリジナル基板からマイクロ発光ダイオードを剥離する。

【0162】

ステップS4300において、非接触の作用力を利用して、マイクロ発光ダイオードを受け基板に予め設置された接続パッドと接触させる。

【0163】

非接触の作用力とは、このような作用力自体を印加する時、物体同士の直接接触が要らないことを指す。例えば、非接触の作用力は、磁場を介して印加することができる。これは異方性導電層の接着性及び液体（例えば、フラックス）の表面張力を利用して印加する作用力と異なる。当業者であれば、非接触の作用力自体の印加には物体同士の直接接触が要らないが、非接触の作用力により物体同士の直接接触を保持することができることを理解すべきである。例えば、以下に非接触の作用力の幾つかの実例を提供する。

【0164】

例えば、前記非接触の作用力は重力である。マイクロ発光ダイオードは受け基板の上方に位置する。剥離を実行した後、重力により、マイクロ発光ダイオードは受け基板に落下され受け基板に残される。

【0165】

例えば、前記非接触の作用力は静電気力である。前記接続パッドに電圧を印加することによって前記静電気力を印加することができる。

【0166】

例えば、前記非接触の作用力は電磁力である。マイクロ発光ダイオードに磁気材料が含まれる場合、磁石（例えば、永久磁石）により磁場を設置することによって、電磁力の作用を利用することができ、よってマイクロ発光ダイオードをオリジナル基板から剥離させた後、受け基板に残し、直接又は間接に接続パッドと接触させる。

【0167】

この実施例では、非接触方式により、マイクロ発光ダイオードを受け基板に付着させるが、これは従来技術に想定されていないものである。

【0168】

例えば、マイクロ発光ダイオードの電極は半田突起を含む。例えば、リフロー半田付けなどにより、前記半田突起を前記接続パッドに接合させる。

【0169】

図10におけるステップ順序は本発明に対する如何なる制限を構成しない。例えば、図10にはステップS4200がステップS4300の前であると示されているが、重力、静電気力又は電磁力は、例えば、ステップS4200の前又はステップS4200を実行する時に印加されてもよい。言い換えると、例えば、ステップS4200の前又はステップS4200と共にステップS4300を実行することができる。

【0170】

同様に、更に、この搬送方法をマイクロ発光ダイオード装置を製造する方法に応用することによって、マイクロ発光ダイオードを受け基板に搬送することができる。前記受け基板は、例えば、ディスプレイパネル又は表示基板である。前記マイクロ発光ダイオード装置は、例えば、ディスプレイ装置である。

【0171】

例えば、更に、前記製造方法を使用することでマイクロ発光ダイオード装置、例えばディスプレイ装置を製造することができる。

【0172】

例えば、本発明は、電子機器を更に含む。該電子機器は、前記マイクロ発光ダイオード装置を含む。該電子機器は、例えば、携帯電話、タブレットPCなどであってもよい。

【0173】

10

20

30

40

50

図 11 は、本発明のまた別の実施例によるマイクロ発光ダイオードの欠陥を修復する方法を示すフローチャートである。

【0174】

図 11 に示すように、ステップ S5100 において、受け基板におけるマイクロ発光ダイオードの欠陥パターンを取得する。

【0175】

例えば、自動目視検査、フォトルミネッセンス、電子光学検知、電気特性測定などにより、欠陥パターンを取得することができる。これらの検出方式は本発明の改善されたところではなく、従来技術であってもよいため、ここで、その詳細な説明を省略する。

【0176】

ステップ S5200 において、レーザー光透過性を有する修復キャリア基板に欠陥パターンに対応するマイクロ発光ダイオードを形成する。

【0177】

一実施例において、まず欠陥パターンでマイクロ発光ダイオードを仮基板に取り付けることができる。

【0178】

例えば、前記仮基板は剛性のもの、例えば PET 板である。例えば、仮基板には接着剤、例えば、紫外線照射テープが塗布されている。よって、レーザー光透過性を有するオリジナル基板におけるマイクロ発光ダイオードを接着剤と接触させることができる。続いて、欠陥パターンに従って、レーザー光でオリジナル基板を照射し、オリジナル基板からマイクロ発光ダイオードを剥離する。部分接着剤を放出することによって、欠陥パターンに従った剥離後のマイクロ発光ダイオードは仮基板に残し、剥離されていないマイクロ発光ダイオードを放出する。部分接着剤が放出された後、剥離されていないマイクロ発光ダイオードは依然としてオリジナル基板に残される。部分接着剤の放出とは、放出後、接着剤の残留接着力は既に剥離されたマイクロ発光ダイオードを十分にオリジナル基板から離脱させるが、剥離されていないマイクロ発光ダイオードはオリジナル基板から離脱させることができないことを指す。

【0179】

続いて、仮基板におけるマイクロ発光ダイオードを修復キャリア基板に搬送する。例えば、まず仮基板におけるマイクロ発光ダイオードを修復キャリア基板に結合させることができる。仮基板におけるマイクロ発光ダイオードは、例えば、ポリマーフィルムを介して修復キャリア基板に結合されることができる。続いて、完全接着剤を放出することによって、マイクロ発光ダイオードを仮基板から剥離する。例えば、マイクロ発光ダイオードを仮基板から剥離した後にポリマーフィルムの少なくとも一部、例えば、マイクロ発光ダイオードの間のポリマーフィルム部分を除去する。

【0180】

例えば、UV 露光により前記部分接着剤の放出と完全接着剤の放出を実行することができる。一般的に、部分接着剤の放出に使用される露光時間又はエネルギーは標準露光時間又はエネルギーより小さく、すなわち、部分放出の露光時間は標準時間より小さく、及び / 又は、部分放出のエネルギーは標準エネルギーより小さい。完全接着剤の放出に使用される露光時間又はエネルギーは標準露光時間又はエネルギーより大きい又は等しく、すなわち、完全に放出される露光時間は標準時間より大きい又は等しく、及び / 又は、完全に放出されるエネルギーは標準エネルギーより大きい又は等しい。標準露光時間又はエネルギーとは、ちょうど、接着剤を完全に放出させるために必要な露光時間又はエネルギーであってもよく、又は公称露光時間又はエネルギーであってもよいことを指す。

【0181】

ステップ S5300 において、修復キャリア基板におけるマイクロ発光ダイオードを受け基板における欠陥位置に合わせ、欠陥位置の接続パッドと接触させる。

【0182】

ステップ S5400 において、修復キャリア基板側からレーザー光で修復キャリア基板を

10

20

30

40

50

照射することにより、修復キャリア基板からマイクロ発光ダイオードを剥離する。

【0183】

例えば、修復キャリア基板はサファイア基板である。上記のように、本発明において、採用される基板はレーザー光透明性を有する。言い換えると、剥離されるマイクロ発光ダイオードのデバイスなどに比べ、照射しようとするレーザー光に対して、該基板は透明であり、すなわち、更に高い透光率を有する。そのため、照射される時、レーザー光のエネルギーは主にその後側のデバイス（マイクロ発光ダイオード）に吸収され、剥離を実現する。当然ながら、レーザー光透過性を有する基板とデバイスの間の透光率の差が大きいほど、剥離の効果は良い。

【0184】

該また別の実施例において、本発明は、更にマイクロ発光ダイオード装置を製造する方法を提供する。該製造方法は、前記実施例によるマイクロ発光ダイオードの欠陥を修復する方法を使用して受け基板におけるマイクロ発光ダイオードの欠陥を修復することを含む。前記受け基板は、例えば、ディスプレイパネル又は表示基板である。前記マイクロ発光ダイオード装置は、例えば、表示装置である。

10

【0185】

該また別の実施例において、本発明は、更にマイクロ発光ダイオード装置、例えば表示装置を提供する。前記実施例によるマイクロ発光ダイオード装置を製造する方法を使用することで前記マイクロ発光ダイオード装置を製造することができる。

【0186】

該また別の実施例において、本発明は、更に電子機器を提供する。該電子機器は前記実施例によるマイクロ発光ダイオード装置を含む。該電子機器は、例えば、携帯電話、タブレットPCなどであってもよい。

20

【0187】

大型マイクロ発光ダイオードが受け基板に搬送された後、一定の歩留まり損失が発生する。そのため、多くの場合、製品の品質を保証するために修復を実行しなければならない。従来技術においてはピックアップヘッドを用いて修復を実行する。従来技術の修復方式は比較的複雑であり、且つ効率が低い。本発明による修復方式は比較的簡単であり、及び／又は高い効率を有する。

【0188】

図12A～図12Fは本発明によるマイクロ発光ダイオードの欠陥を修復するのに用いられる一実例を示す。

30

【0189】

図12Aに示すように、オリジナル基板701にはマイクロ発光ダイオード703が形成されている。マイクロ発光ダイオード703は、欠陥のあるマイクロ発光ダイオードと良好なマイクロ発光ダイオードを含む。マイクロ発光ダイオードを接着剤層704を介して仮基板705に取り付ける。接着剤層704は、例えば紫外線照射テープである。前記仮基板705は、例えばPET板である。欠陥パターンに従って、レーザー光702でオリジナル基板701を照射することにより、オリジナル基板から欠陥のあるマイクロ発光ダイオードを剥離する。

40

【0190】

図12Bに示すように、仮基板705側から紫外線706で接着剤層（紫外線照射テープ）704を部分的に露光させる。

【0191】

図12Cに示すように、部分的に露光された後、接着剤層704は依然として一定の残留接着性を有し、既にレーザー光リフトオフされたマイクロ発光ダイオード703bを十分にオリジナル基板から離脱させるが、レーザー光リフトオフされていないマイクロ発光ダイオード703aは依然としてオリジナル基板に残される。欠陥パターンでマイクロ発光ダイオードに対するレーザー光リフトオフを実行するため、接着剤層704（又は仮基板705）には欠陥パターンに基づいて配列された良好なマイクロ発光ダイオードがある。

50

【0192】

図12Dに示すように、ポリマーフィルム708を接合させることにより接着剤層704におけるマイクロ発光ダイオード703bを修復キャリア基板707に仮結合させる。続いて、接着剤層704を完全に露光させる。図12Eに示すように、接着剤層704はマイクロ発光ダイオード703bから分離される。図12Fは修復を行うのに用いられる修復キャリア基板707及びその上の欠陥パターンに基づくマイクロ発光ダイオード703bを示している。図12Fに示すように、更に、マイクロ発光ダイオード703bの間の接合ポリマーフィルム708を除去し、マイクロ発光ダイオード703bと基板707との間のフィルム部分だけを残すことができる。

【0193】

続いて、レーザー光リフトオフの方式により、修復キャリア基板707を受け基板における欠陥を修復するのに用いることができる。

【0194】

図13は本発明のまた別の例示的な実施例による欠陥のあるマイクロ発光ダイオードを事前排除するのに用いられる方法を示すフローチャートである。

【0195】

図13に示すように、ステップS6100において、レーザー光透過性を有する基板における欠陥のあるマイクロ発光ダイオードの欠陥パターンを取得する。

【0196】

例えば、自動目視検査、フォトルミネッセンス、電子光学検知又は電気特性測定により、欠陥パターンを取得することができる。

【0197】

ステップS6200において、欠陥パターンに従って、レーザー光透過性を有する基板側からレーザー光でレーザー光透過性を有する基板を照射することにより、レーザー光透過性を有する基板から欠陥のあるマイクロ発光ダイオードを剥離する。

【0198】

一実施例において、剥離されたマイクロ発光ダイオードがレーザー光透過性基板を離脱するように、接触の方式により作用力を印加する。例えば、レーザー光透過性を有する基板におけるマイクロ発光ダイオードを紫外線照射テープに取り付けることができる。例えば、紫外線照射テープは剛性の支持体に付着されている。レーザー光を介して欠陥のあるマイクロ発光ダイオードを紫外線照射テープに剥離し、UV露光により欠陥のないマイクロ発光ダイオードをレーザー光透過性を有する基板に残す。

【0199】

別の実施例において、非接触の作用力を利用して、レーザー光透過性基板から欠陥のあるマイクロ発光ダイオードを剥離することができる。前述のように、非接触の作用力は接触の方式により印加する必要がない。例えば、非接触の作用力は重力、静電気力と電磁力の少なくとも1つである。前述の方式でこれらの作用力を印加することができる。

【0200】

本発明によれば、マイクロ発光ダイオードが受け基板に搬送された後に修復を行うことができる以外に、又は、更に前記搬送の前にレーザー光透過性を有する基板において修復を行うこともできる。例えば、レーザー光透過性を有する基板において、剥離されたマイクロ発光ダイオードの位置に良好なマイクロ発光ダイオードを形成する。前述の修復方法を利用することによって、欠陥位置に良好なマイクロ発光ダイオードを形成することができる。

【0201】

また別の実施例において、本発明は、更にマイクロ発光ダイオード装置を製造する方法を提供する。該製造方法は、前記実施例による欠陥のあるマイクロ発光ダイオードを事前排除する方法を使用してレーザー光透過性を有する基板における欠陥のあるマイクロ発光ダイオードを事前排除することを含む。前記受け基板は、例えば、ディスプレイパネル又は表示基板である。前記マイクロ発光ダイオード装置は、例えば表示装置である。

【 0 2 0 2 】

該また別の実施例において、本発明は、更にマイクロ発光ダイオード装置、例えば表示装置を提供する。前記実施例によるマイクロ発光ダイオード装置を製造する方法を使用することで前記マイクロ発光ダイオード装置を製造することができる。

【 0 2 0 3 】

該また別の実施例において、本発明は、更に電子機器を提供する。該電子機器は、前記実施例によるマイクロ発光ダイオード装置を含む。該電子機器は、例えば、携帯電話、タブレットPCなどであってもよい。

【 0 2 0 4 】

従来技術において、搬送を行う時、基板における良好なマイクロ発光ダイオードと欠陥のあるマイクロ発光ダイオードは、いずれも受け基板に搬送される。しかし、本発明の技術的解決手段によれば、周知の良好なマイクロ発光ダイオードのみが受け基板に搬送される。

10

【 0 2 0 5 】

図 1 4 A ~ 図 1 4 C は本発明による欠陥のあるマイクロ発光ダイオードを事前排除するのに用いられる一実例を示す。

【 0 2 0 6 】

この実例において、まず例えば、自動目視検査、フォトルミネッセンス、電子光学検知又は電気特性測定などによりレーザー光透過性を有する基板における欠陥パターンを取得する。続いて、レーザー光透過性を有する基板を紫外線照射テープに取り付ける。図 1 4 A に示すように、紫外線照射テープ 8 0 4 は支持体 8 0 5 に位置する。レーザー光透過性を有する基板 8 0 1 は、マイクロ発光ダイオード 8 0 3 を介して紫外線照射テープ 8 0 4 に取り付けられる。欠陥パターンに従って、レーザー光 8 0 2 で基板 8 0 1 を照射し、基板 8 0 1 から欠陥のあるマイクロ発光ダイオードを剥離する。

20

【 0 2 0 7 】

図 1 4 B に示すように、支持体 8 0 5 側から紫外線 8 0 6 で紫外線照射テープ 8 0 4 を部分的に露光させる。

【 0 2 0 8 】

図 1 4 C に示すように、部分的に露光された後、紫外線照射テープ 8 0 4 は依然として一定の残留接着性を有し、既にレーザー光リフトオフされたマイクロ発光ダイオード 8 0 3 b を十分に基板 8 0 1 から離脱させ、レーザー光リフトオフされていないマイクロ発光ダイオード 8 0 3 a は依然として基板 8 0 1 に残される。

30

【 0 2 0 9 】

図 1 5 A ~ 図 1 5 B は本発明による欠陥のあるマイクロ発光ダイオードを事前排除するのに用いられる別の実例を示す。

【 0 2 1 0 】

図 1 5 A に示すように、基板（ウェハ）9 0 1 には良好なマイクロ発光ダイオード 9 0 2 と欠陥のあるマイクロ発光ダイオード 9 0 3 がある。本発明による方法により、マイクロ発光ダイオードを基板 9 0 1 から受け基板（図示せず）に搬送する前に、欠陥のあるマイクロ発光ダイオード 9 0 3 を事前排除する。図 1 5 B は欠陥のあるマイクロ発光ダイオードを事前排除した後の基板 9 0 1 を示す。

40

【 0 2 1 1 】

図 1 6 A ~ 図 1 6 B は、図 1 5 B におけるブロック A に示された領域の拡大図である。図 1 6 A に示すように、位置 9 0 3 a における欠陥のあるマイクロ発光ダイオードは事前排除される。図 1 6 B に示すように、直接基板 9 0 1 において修復を実行することにより、位置 9 0 3 a に良好なマイクロ発光ダイオードを形成することができる。好ましくは、マイクロ発光ダイオードを基板 9 0 1 から受け基板に搬送した後に前記修復を実行してもよい。

【 0 2 1 2 】

図 1 7 は本発明によるウェハレベルでマイクロ発光ダイオードを搬送する方法のまた別の

50

例示的な実施例を示すフローチャートである。

【0213】

図17に示すように、ステップS7100において、レーザー光透過性を有するオリジナル基板におけるマイクロ発光ダイオードを第1接合層を介してキャリア基板に仮接合させる。

【0214】

例えば、前記第1接合層はUV剥離テープ又は光剥離テープであってもよい。例えば、前記キャリア基板はPET板であってもよい。PET板は剛性のものであり、UV剥離テープ又は光剥離テープを十分に支持することができ、搬送されたマイクロ発光ダイオードが変位することを防止する。

10

【0215】

ステップS7200において、オリジナル基板側からレーザー光でオリジナル基板を照射することにより、オリジナル基板から、選択されたマイクロ発光ダイオードを剥離する。

【0216】

ステップS7300において、第1接合層に対する部分的放出を実行し、よって選択されたマイクロ発光ダイオードをキャリア基板に搬送する。

【0217】

例えば、前記第1接合層を照射する紫外線又は光の強度及び/又は照射の時間を制御することによって第1接合層の放出程度を制御することができる。

【0218】

一実施例において、剥離されたマイクロ発光ダイオードをキャリア基板に搬送することを十分に保証するために、部分的放出を実行する時、前記マイクロ発光ダイオードに非接触の作用力を印加することができる。例えば、前記非接触の作用力は重力、静電気力と電磁力の少なくとも1つである。

20

【0219】

ステップS7400において、キャリア基板におけるマイクロ発光ダイオードを第2接合層を介して搬送ヘッド基板に仮接合させる。

【0220】

ステップS7500において、第1接合層に対する完全放出を実行することにより、前記マイクロ発光ダイオードを搬送ヘッド基板に搬送する。

30

【0221】

例えば、紫外線又は光を用いて露光させることによって、前記部分的放出と完全放出を実行することができる。

【0222】

ステップS7600において、搬送ヘッド基板におけるマイクロ発光ダイオードを受け基板に接合させる。

【0223】

ステップS7700において、第2接合層を放出し、搬送ヘッド基板を除去することによって、マイクロ発光ダイオードを受け基板に搬送する。

【0224】

例えば、放熱により前記第2接合層を放出することができる。一実施例において、搬送されたマイクロ発光ダイオードは垂直構造である。垂直構造のマイクロ発光ダイオードを使用することによって更に高解像度の表示パネルを提供することができる。搬送過程に、垂直構造のマイクロ発光ダイオードは未完成のマイクロ発光ダイオードである。そのため、マイクロ発光ダイオードを受け基板に搬送した後、受け基板におけるマイクロ発光ダイオードにN電極を形成し、N電極においてパッケージングを行うことによって、完全なマイクロ発光ダイオードを形成する。

40

【0225】

表示パネルの良品率を向上させるために、冗長方式で前記マイクロ発光ダイオードを受け基板に配置することができる。

50

【 0 2 2 6 】

また別の実施例において、本発明は、更にマイクロ発光ダイオード装置を製造する方法を提供する。該製造方法は、前記実施例によるウェハレベルでマイクロ発光ダイオードを搬送する方法を使用してマイクロ発光ダイオードをマイクロ発光ダイオード装置の受け基板に搬送することを含む。前記受け基板は、例えば、ディスプレイパネル又は表示基板である。前記マイクロ発光ダイオード装置は、例えば表示装置である。

【 0 2 2 7 】

該また別の実施例において、本発明は、更にマイクロ発光ダイオード装置、例えば表示装置を提供する。前記実施例によるマイクロ発光ダイオード装置を製造する方法を使用することで前記マイクロ発光ダイオード装置を製造することができる。

10

【 0 2 2 8 】

該また別の実施例において、本発明は、更に電子機器を提供する。該電子機器は前記実施例によるマイクロ発光ダイオード装置を含む。該電子機器は、例えば、携帯電話、タブレットPCなどであってもよい。

【 0 2 2 9 】

図 1 8 A ~ 図 1 8 J は本発明によるウェハレベルでマイクロ発光ダイオードの搬送する一実例を示す。

【 0 2 3 0 】

図 1 8 A に示すように、レーザー光透過性を有するオリジナル基板 1 0 0 1 にマイクロ発光ダイオードを形成する。図 1 8 A には赤色マイクロ発光ダイオード 1 0 0 3 r が示されている。オリジナル基板 1 0 0 1 は、例えばサファイア基板である。

20

【 0 2 3 1 】

マイクロ発光ダイオード 1 0 0 3 r を第 1 接合層を介してキャリア基板 1 0 0 5 に仮接合させる。例えば、前記第 1 接合層 1 0 0 4 は UV 剥離テープ又は光剥離テープであってもよい。例えば、示されたキャリア基板は PET 板であってもよい。

【 0 2 3 2 】

図 1 8 A において、オリジナル基板側からレーザー光 1 0 0 2 でオリジナル基板 1 0 0 1 を照射することにより、オリジナル基板から、選択されたマイクロ発光ダイオードを剥離する。

【 0 2 3 3 】

図 1 8 B に示すように、第 1 接合層 1 0 0 4 に対する部分的放出を実行する。図 1 8 C に示すように、選択されたマイクロ発光ダイオード 1 0 0 3 r をキャリア基板 1 0 0 5 に搬送する。

30

【 0 2 3 4 】

例えば、前記第 1 接合層を照射する紫外線又は光 1 0 0 6 の強度及び / 又は照射の時間を制御することによって第 1 接合層 1 0 0 4 の放出程度を制御することができる。

【 0 2 3 5 】

部分的放出の効果を向上させるために、更に前記マイクロ発光ダイオードに非接触の作用力を印加することができる。例えば、前記非接触の作用力は重力、静電気力と電磁力の少なくとも 1 つである。

40

【 0 2 3 6 】

続いて、図 1 8 D において、マイクロ発光ダイオード 1 0 0 3 r を第 2 接合層を介して搬送ヘッド基板 1 0 0 8 に仮接合させる。

【 0 2 3 7 】

図 1 8 E において、第 1 接合層 1 0 0 4 に対する完全放出を実行する。図 1 8 F において、前記マイクロ発光ダイオード 1 0 0 3 r は搬送ヘッド基板 1 0 0 8 に搬送される。

【 0 2 3 8 】

例えば、紫外線又は光を用いて露光させることによって、前記部分的放出と完全放出を実行することができる。

【 0 2 3 9 】

50

図 18 G と図 18 H は、それぞれ搬送ヘッド基板 1010 と搬送ヘッド基板 1012 を示す。搬送ヘッド基板 1010 は、緑色マイクロ発光ダイオード 1003 g と第 2 接合層 1009 を有する。搬送ヘッド基板 1012 は、青色マイクロ発光ダイオード 1003 b と第 2 接合層 1011 を有する。

【0240】

図 18 I において、搬送ヘッド基板におけるマイクロ発光ダイオード 1003 r を受け基板 1013 に接合させることによって、搬送を完了させる。

【0241】

図 18 J において、第 2 接合層が放出され、且つ搬送ヘッド基板が除去される。赤色、緑色と青色マイクロ発光ダイオード 1003 r、1003 g、1003 b は受け基板 1013 に搬送される。

10

【0242】

例えば、放熱により前記第 2 接合層を放出することができる。上記マイクロ発光ダイオードは垂直構造であってもよい。そのため、マイクロ発光ダイオードを受け基板 1013 に搬送した後、マイクロ発光ダイオードに N 電極を形成し、N 電極においてパッケージングを行うことによって、完全なマイクロ発光ダイオード（図示せず）を形成する。

【0243】

図 19 は本発明によるマイクロ発光ダイオードを搬送する方法のまた別の例示的な実施例を示すフローチャートである。

【0244】

20

図 19 に示すように、ステップ S8100 において、レーザー光透過性を有するオリジナル基板の裏面にマスク層を形成し、マイクロ発光ダイオードはオリジナル基板の表面に位置する。例えば、オリジナル基板はサファイア基板であってもよい。オリジナル基板の厚さ範囲は 20 ~ 1000 μm 、又は 50 ~ 500 μm 、又は 100 ~ 300 μm であってもよい。

【0245】

本実施例において、マスク層を使用することでマイクロ発光ダイオードを選択的に剥離し、更に高い画面解像度を提供することができる。従来技術において、画面解像度は一般的に 50 μm より大きい。例えば、本発明によれば、前記マスク層の空間分解能の範囲は 1 ~ 50 μm であってもよい。

30

【0246】

例えば、前記マスク層の材料は、フォトレジスト、ポリマー、金属 / 金属化合物、金属 / 金属合金、金属 / 金属合成物、シリコン、シリサイドから選ばれる。例えば、前記マイクロ発光ダイオードは、垂直マイクロ発光ダイオードであってもよく、又は横方向マイクロ発光ダイオードであってもよい。

【0247】

ステップ S8200 において、オリジナル基板におけるマイクロ発光ダイオードを受け基板に予め設置された接続パッドと接触させる。

【0248】

例えば、前記マイクロ発光ダイオードはマイクロバンプ接合を介して前記接続パッドと接触する。前記マイクロバンプ接合は、例えば、半田、合金、金属、半田ペースト、接着剤、導電性インクなどであってもよい。

40

【0249】

ステップ S8300 において、オリジナル基板側からマスク層を介してレーザー光でオリジナル基板を照射することにより、オリジナル基板からマイクロ発光ダイオードを剥離する。例えば、オリジナル基板からマイクロ発光ダイオードを剥離する時、前記マイクロ発光ダイオードに非接触の作用力を印加することができ、それによりマイクロ発光ダイオードの剥離を確保する。例えば、前記非接触の作用力は重力、静電気力と電磁力の少なくとも 1 つである。

【0250】

50

本発明において、マスクを使用することで剥離しようとするマイクロ発光ダイオードを選択するため、レーザービームに対する制御を簡略化することができる。例えば、レーザー光を制御することで剥離しようとするマイクロ発光ダイオードを選択する必要がある。更に、本発明は、寸法の小さいレーザー光を使用することで解像度を向上させる必要がないため、レーザービームの寸法に対する要求を低減させる。一実施例において、レーザービームの寸法が大きいレーザー光を使用することで剥離の速度を向上させることができる。例えば、前記レーザー光のレーザービームの寸法は50～5000μmである。

【0251】

一実施例において、製造の良品率を向上させるために、冗長方式で前記マイクロ発光ダイオードを受け基板に配置することができる。

10

【0252】

また別の実施例において、本発明は、更にマイクロ発光ダイオード装置を製造する方法を提供する。該製造方法は、前記実施例によるマイクロ発光ダイオードを搬送する方法を使用してマイクロ発光ダイオードをマイクロ発光ダイオード装置の受け基板に搬送することを含む。前記受け基板は、例えば、ディスプレイパネル又は表示基板である。前記マイクロ発光ダイオード装置は、例えば表示装置である。

【0253】

該また別の実施例において、本発明は、更にマイクロ発光ダイオード装置、例えば表示装置を提供する。前記実施例によるマイクロ発光ダイオード装置を製造する方法を使用することで前記マイクロ発光ダイオード装置を製造することができる。

20

【0254】

該また別の実施例において、本発明は、更に電子機器を提供する。該電子機器は、前記実施例によるマイクロ発光ダイオード装置を含む。該電子機器は、例えば、携帯電話、タブレットPCなどであってもよい。

【0255】

図20A～図20Iは、本発明によるマイクロ発光ダイオードを搬送するまた別の实例を示す。

【0256】

図20Aに示すように、例えばサファイア基板などの基板1102rは、その表面に赤色マイクロ発光ダイオード1103rがあり、その裏面にはマスク1101rがある。受け基板1106にはリード線及び接続パッド1105が配置されている。例えば、剥離しようとするマイクロ発光ダイオードに対応する接続パッドに半田1104が配置されている。

30

【0257】

図20Bに示すように、赤色マイクロ発光ダイオード1103rを半田1104を介して接続パッド1105と接触させる。レーザー光1107rを使用しマスク1101rを通じて基板1102rを照射し、赤色マイクロ発光ダイオード1103rを剥離する。この過程に、マイクロ発光ダイオード1103rに非接触の作用力、例えば、重力、静電気力、電磁力などを印加し、十分な剥離を保証することができる。

【0258】

図20Cに示すように、赤色マイクロ発光ダイオード1103rは受け基板1106に搬送される。

40

【0259】

図20Dと図20Eは、緑色マイクロ発光ダイオード1103gを搬送する過程を示す。図20Dに示すように、レーザー光1107gを使用しマスク1101gを通じて基板1102gを照射し、緑色マイクロ発光ダイオード1103gを剥離する。図20Eは剥離後の受け基板1106を示す。

【0260】

図20Fと図20Gは、青色マイクロ発光ダイオード1103bを搬送する過程を示す。図20Fに示すように、レーザー光1107bを使用しマスク1101bを通じて基板1

50

102bを照射し、緑色マイクロ発光ダイオード1103bを剥離する。図20Gは剥離後の受け基板1106を示す。

【0261】

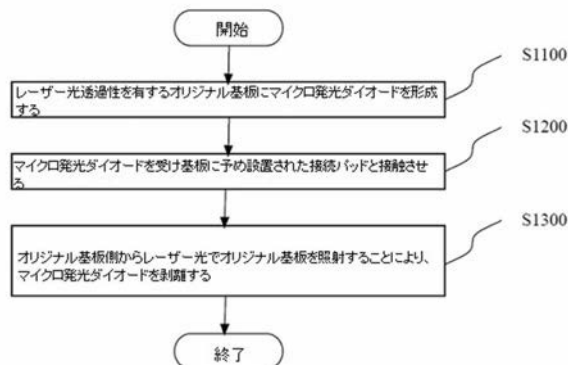
更に、搬送後の受け基板1106に対する後続処理を実行することができる。例えば、マイクロ発光ダイオードは垂直マイクロ発光ダイオードであってもよい。図20Hに示すように、マイクロ発光ダイオード1103r、1103g、1103bに、ポリマー1108を塗布することによって、マイクロ発光ダイオードを保護する。ポリマー1108をエッチングすることによって、マイクロ発光ダイオードのエピタキシャル層を露出させる。図20Iに示すように、マイクロ発光ダイオードのエピタキシャル層にN-金属電極を形成することによって、完全なマイクロ発光ダイオードを形成する。

10

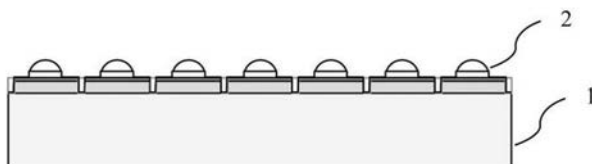
【0262】

既に実例を通じて本発明の幾つかの特定の実施例を詳細に説明したが、当業者であれば、以上の実例は説明するためのものに過ぎず、本発明の範囲を制限するためのものではないことを理解すべきである。当業者であれば、本発明の範囲と趣旨を逸脱しない限り、上記実施例を修正することができることを理解すべきである。本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲により制限される。

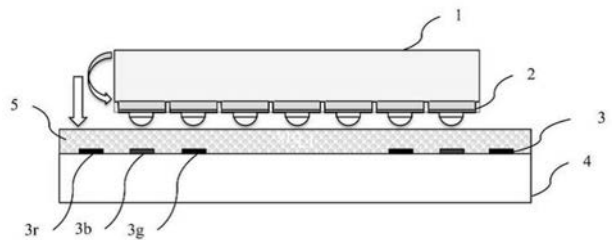
【図1】



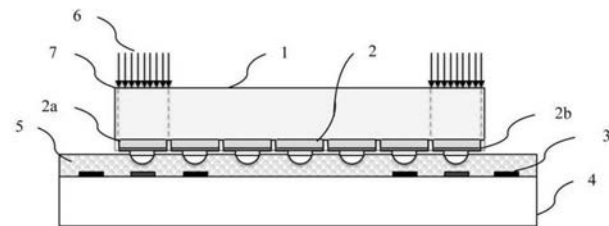
【図2A】



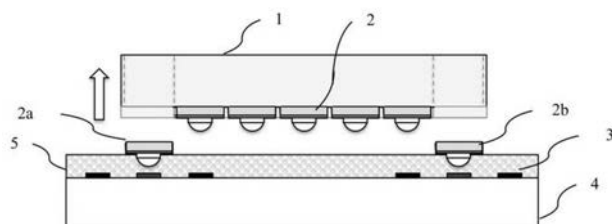
【図2B】



【図2C】



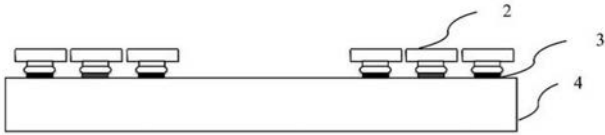
【図2D】



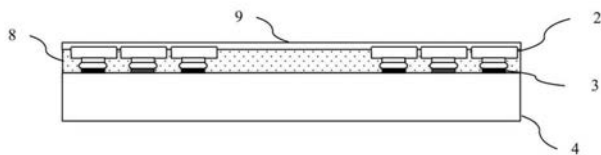
【図 2 E】



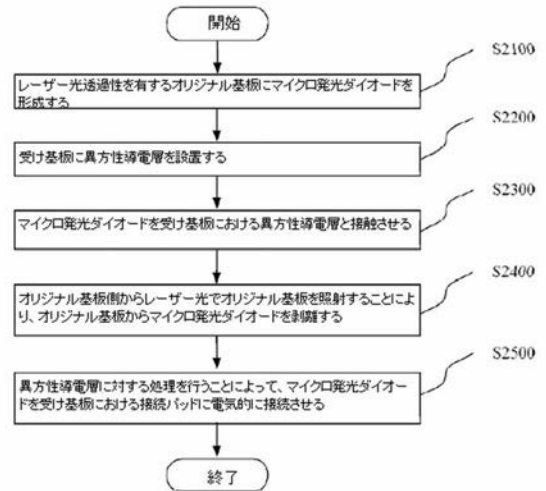
【図 2 F】



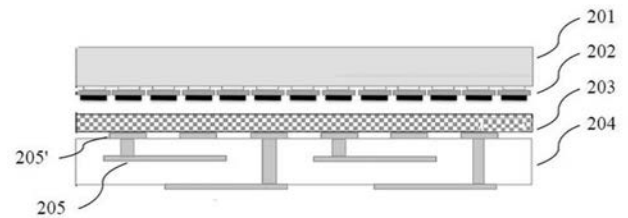
【図 2 G】



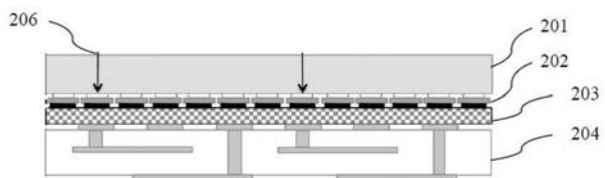
【図 3】



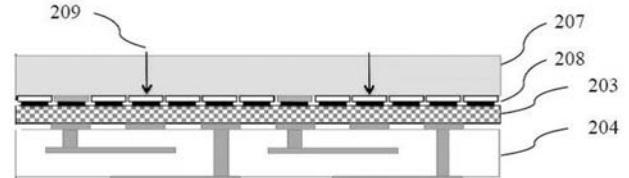
【図 4 A】



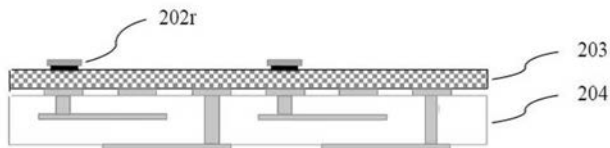
【図 4 B】



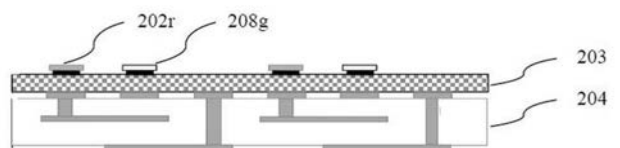
【図 4 E】



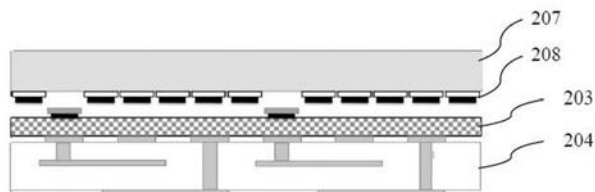
【図 4 C】



【図 4 F】



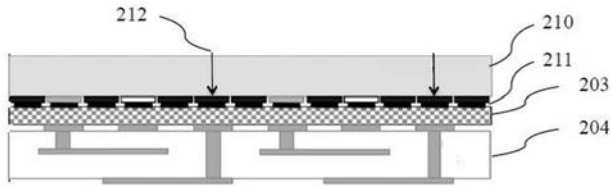
【図 4 D】



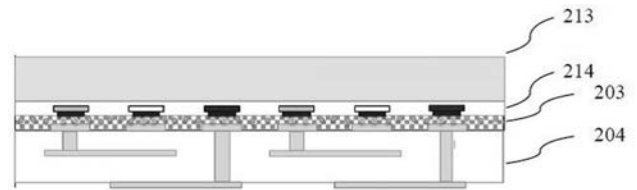
【図 4 G】



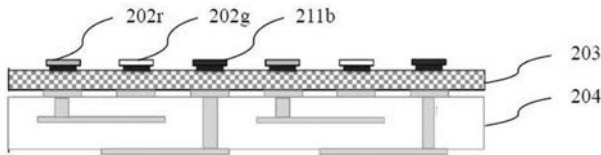
【図 4 H】



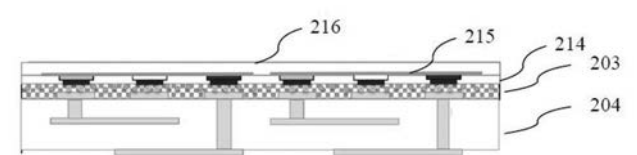
【図 4 K】



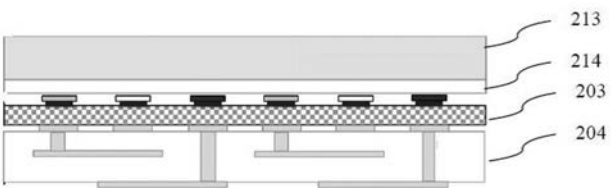
【図 4 I】



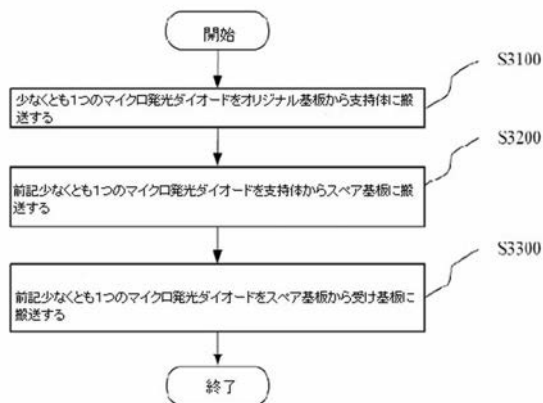
【図 4 L】



【図 4 J】



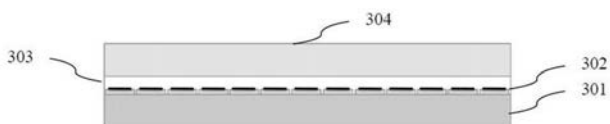
【図 5】



【図 6 A】



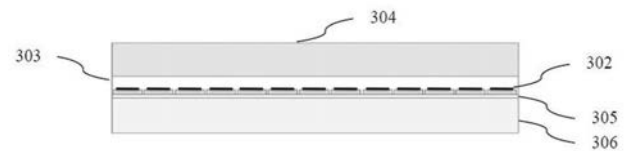
【図 6 B】



【図 6 C】



【図 6 D】



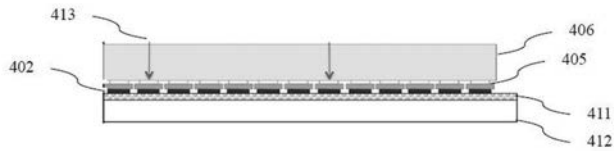
【図 6 E】



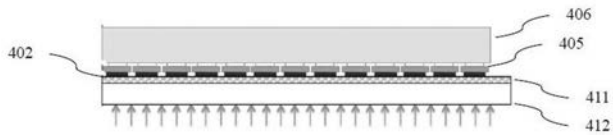
【図 6 F】



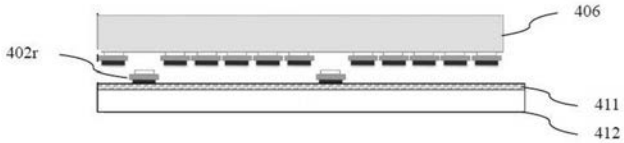
【図 7 A】



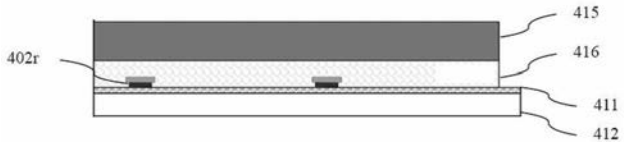
【図 7 B】



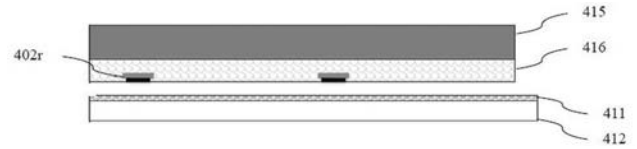
【図 7 C】



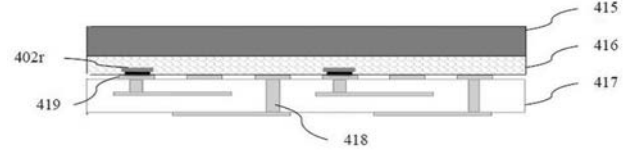
【図 7 D】



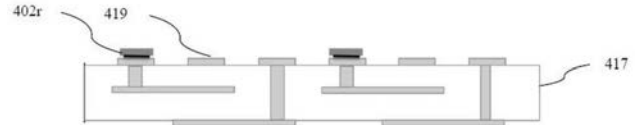
【図 7 E】



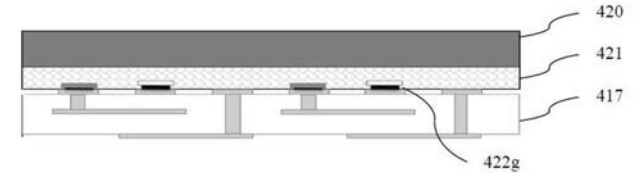
【図 7 F】



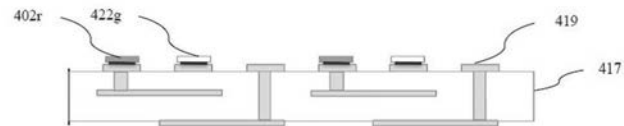
【図 7 G】



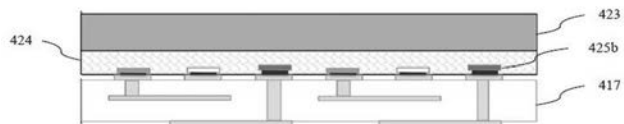
【図 7 H】



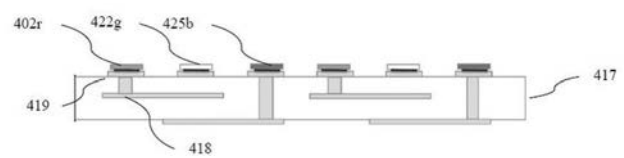
【図 7 I】



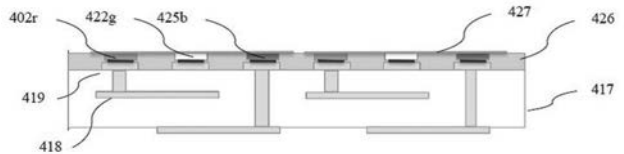
【図 7 J】



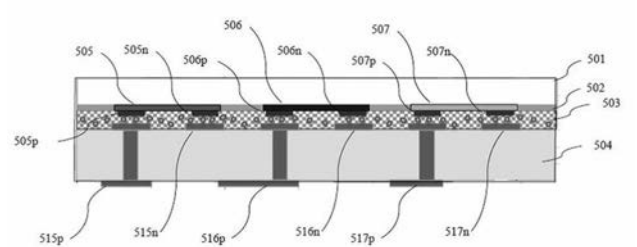
【図 7 K】



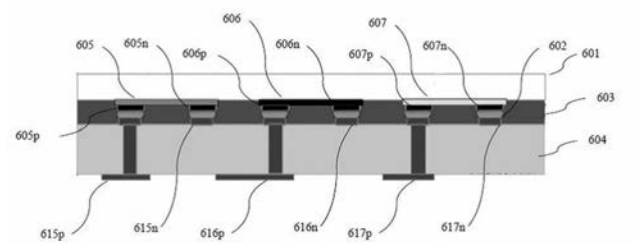
【図 7 L】



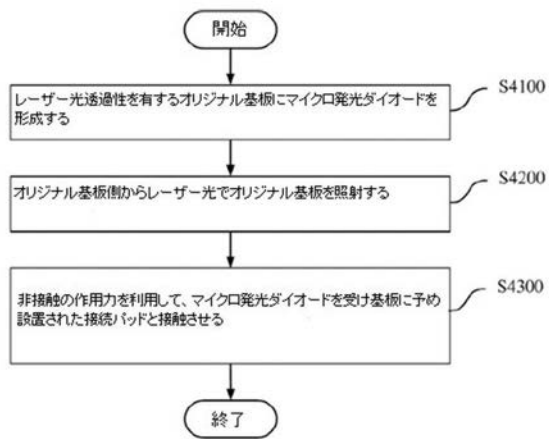
【図 8】



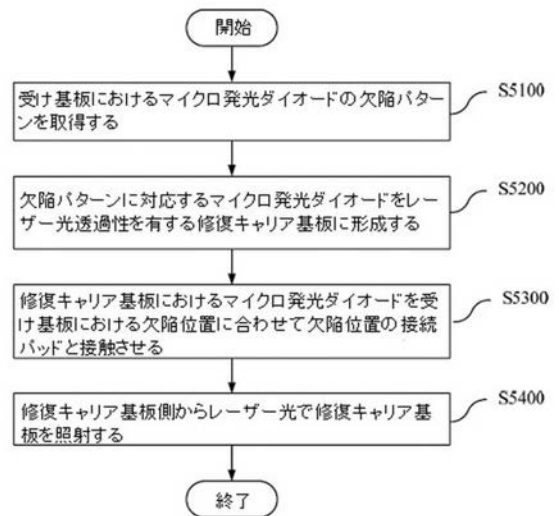
【図 9】



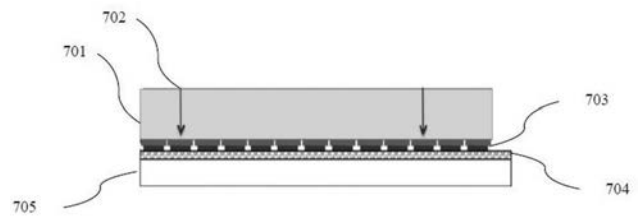
【図 10】



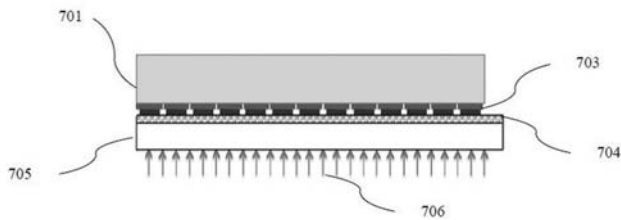
【図 11】



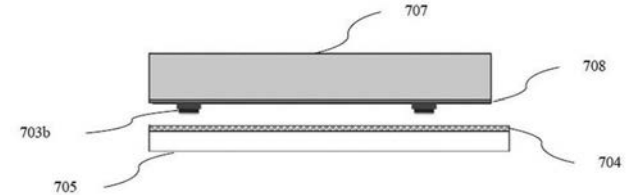
【図 12 A】



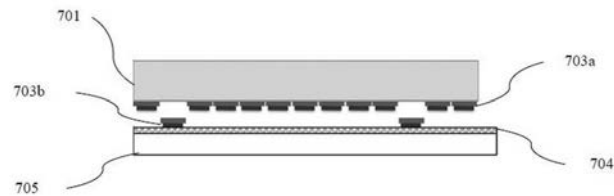
【図 12 B】



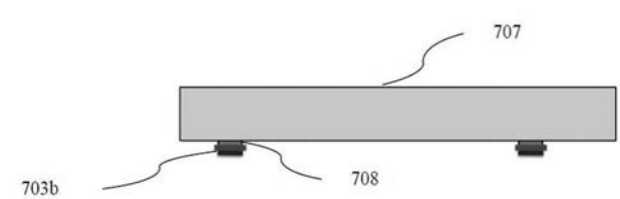
【図 12 E】



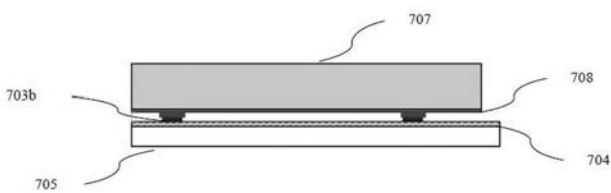
【図 12 C】



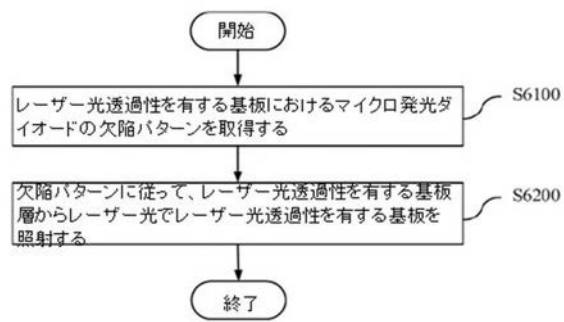
【図 12 F】



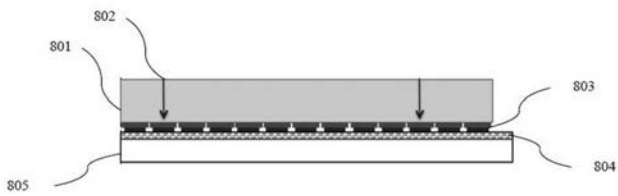
【図 12 D】



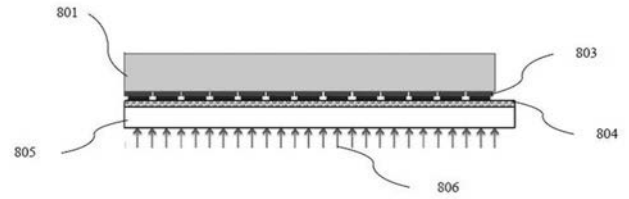
【図 1 3】



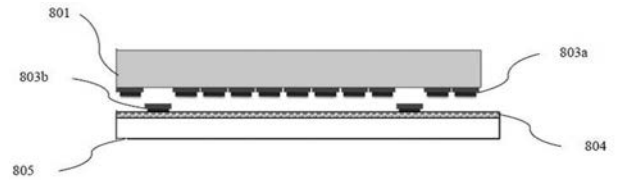
【図 1 4 A】



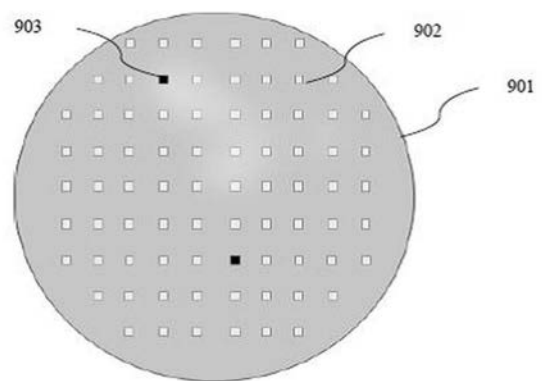
【図 1 4 B】



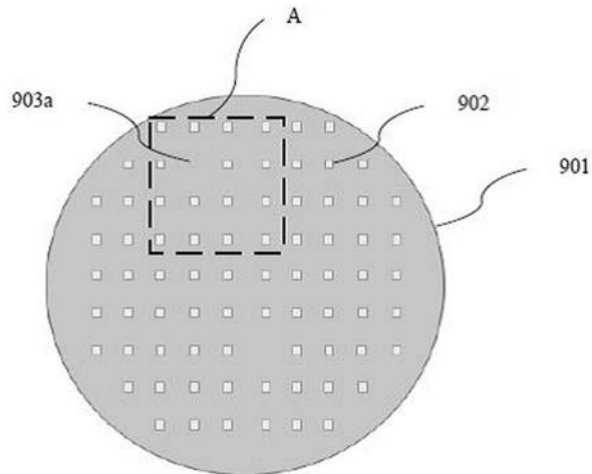
【図 1 4 C】



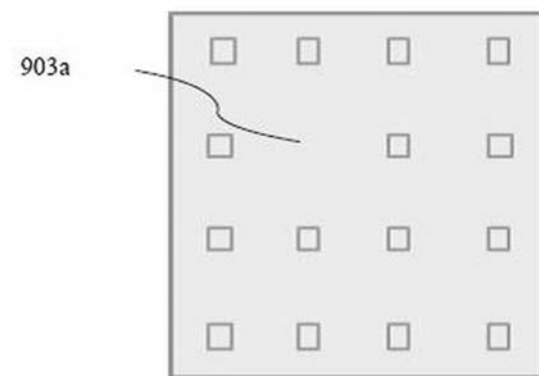
【図 1 5 A】



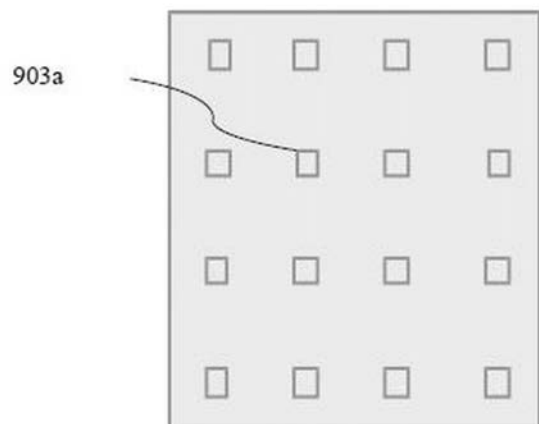
【図 1 5 B】



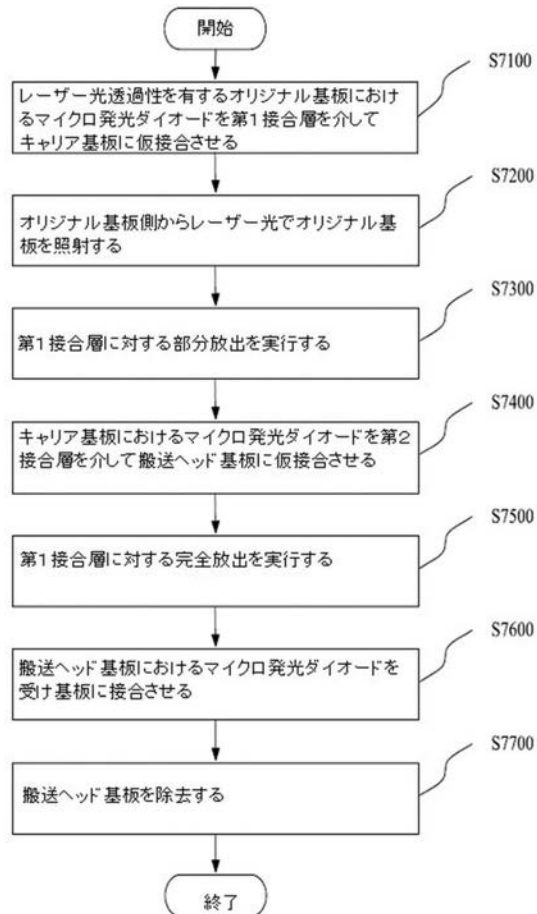
【図 1 6 A】



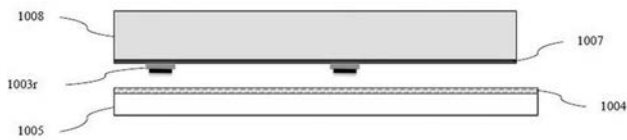
【図 1 6 B】



【図 17】



【図 18 E】



【図 18 F】



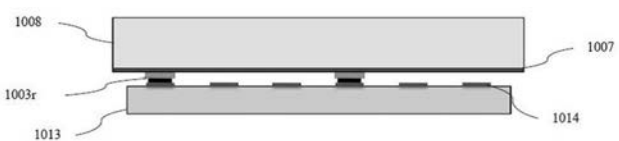
【図 18 G】



【図 18 H】



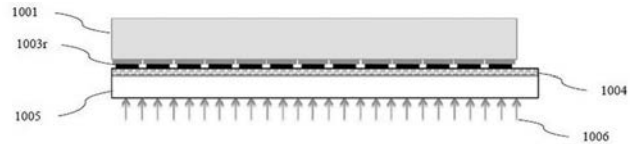
【図 18 I】



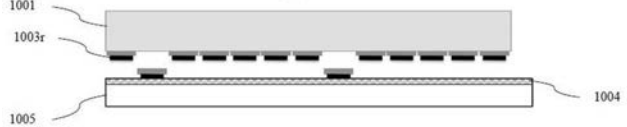
【図 18 A】



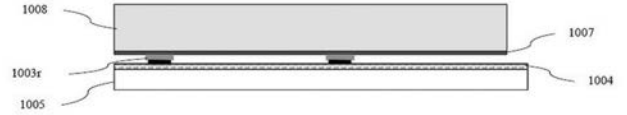
【図 18 B】



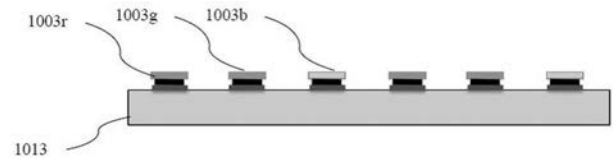
【図 18 C】



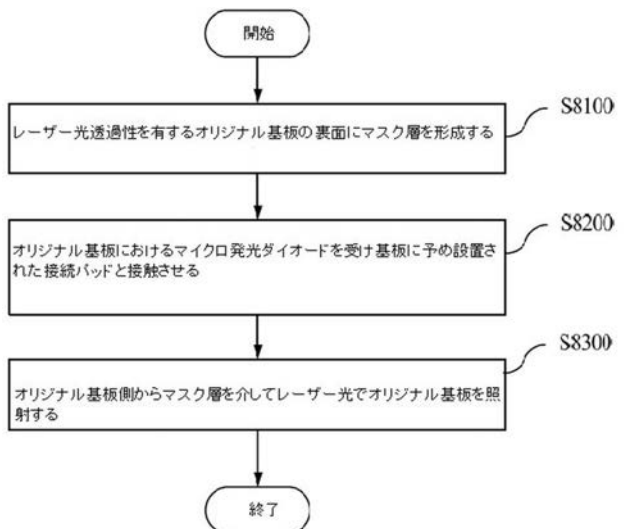
【図 18 D】



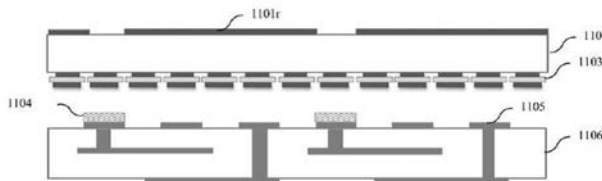
【図 18 J】



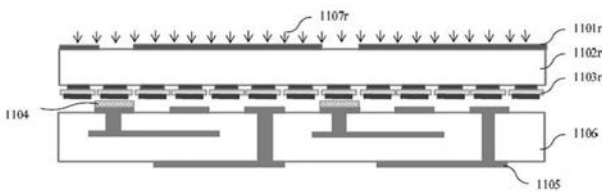
【図 19】



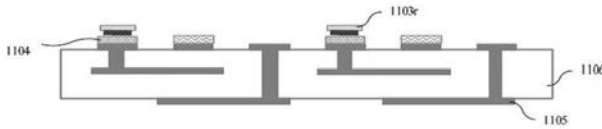
【図 20 A】



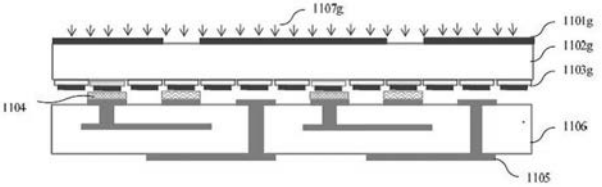
【図 20 B】



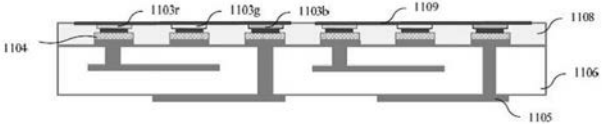
【図 20 C】



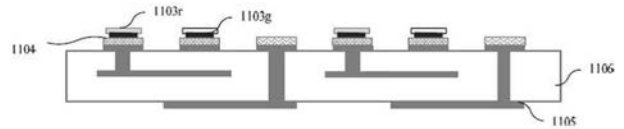
【図 20 D】



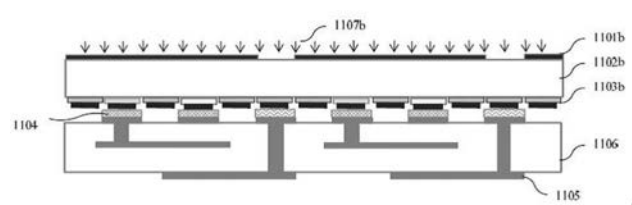
【図 20 E】



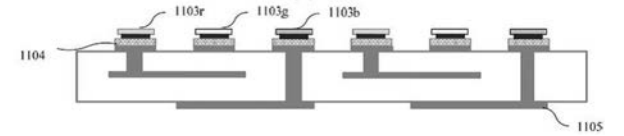
【図 20 F】



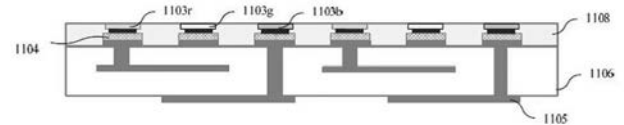
【図 20 G】



【図 20 H】



【図 20 I】



【 国 際 調 査 報 告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2015/093787

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER H01L 33/00(2010.01)i According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) H01L Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CNPAT, CNKI, WPI, EPODOC:LED, mask, backside, substrate, laser, transfer+, irradiat+, GOERTEK		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	CN 103647012 A (INST. SEMICONDUCTORS CHINESE ACAD. SCI.) 19 March 2014 (2014-03-19) description paragraphs [0022]-[0026], figure 2	1-12
A	CN 102509731 A (XIAMEN SANAN PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.) 20 June 2012 (2012-06-20) the whole document	1-12
A	CN 102800778 A (DONGGUAN FORTUNE ELECTRONIC MATERIALS CO.) 28 November 2012 (2012-11-28) the whole document	1-12
A	US 2014355168 A1 (LUXVUE TECHNOLOGY CORP.) 04 December 2014 (2014-12-04) the whole document	1-12
A	CN 1364246 A (RENESAS TECHNOLOGY CORP.) 14 August 2002 (2002-08-14) the whole document	1-12
☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: “A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance “E” earlier application or patent but published on or after the international filing date “L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) “O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means “P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed “T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention “X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone “Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art “&” document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 26 July 2016		Date of mailing of the international search report 18 August 2016
Name and mailing address of the ISA/CN STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE P.R.CHINA 6, Xitucheng Rd., Jimen Bridge, Haidian District, Beijing 100088, China Facsimile No. (86-10)62019451		Authorized officer BAI, Yan Telephone No. (86-10)62413951

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/CN2015/093787

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
CN	103647012	A	19 March 2014	None			
CN	102509731	A	20 June 2012	WO	2013097651	A1	04 July 2013
				US	9269698	B2	23 February 2016
				CN	102509731	B	11 September 2013
				US	2014291708	A1	02 October 2014
CN	102800778	A	28 November 2012	CN	102800778	B	18 March 2015
US	2014355168	A1	04 December 2014	KR	20160005745	A	15 January 2016
				US	2015340262	A1	26 November 2015
				TW	2015111175	A	16 March 2015
				US	9136161	B2	15 September 2015
				CN	105263854	A	20 January 2016
				EP	3003967	A1	13 April 2016
				WO	2014197221	A1	11 December 2014
CN	1364246	A	14 August 2002	JP	4223215	B2	12 February 2009
				CN	1209682	C	06 July 2005
				WO	0102908	A1	11 January 2001
				US	7125651	B2	24 October 2006
				TW	497165	B	01 August 2002
				US	2004063037	A1	01 April 2004
				US	6677107	B1	13 January 2004

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US

(72)発明者 リュウ, マネン

中華人民共和国 261031 シャントン, ウェイファン, ハイ - テク インダストリー ディ
ストリクト, ドンファン ロード 268

(72)発明者 ワン, ジュ

中華人民共和国 261031 シャントン, ウェイファン, ハイ - テク インダストリー ディ
ストリクト, ドンファン ロード 268

Fターム(参考) 5F142 AA82 BA32 CA11 CA13 CB14 CD15 CD16 CD17 CD23 CD25

CD44 CD47 FA32 FA40 FA50 GA01 GA40

专利名称(译)	转移微变色二极管二极管的方法		
公开(公告)号	JP2018517298A	公开(公告)日	2018-06-28
申请号	JP2017560320	申请日	2015-11-04
[标]申请(专利权)人(译)	歌尔声学股份有限公司		
[标]发明人	ゾウクアンボ リュウマネン ワンジュ		
发明人	ゾウ,クアンボ リュウ,マネン ワン,ジュ		
IPC分类号	H01L33/62		
CPC分类号	H01L25/0753 H01L33/0093 H01L33/0095 H01L33/20 H01L2224/95 H01L21/68 H01L21/786 H01L27/15		
FI分类号	H01L33/62		
F-TERM分类号	5F142/AA82 5F142/BA32 5F142/CA11 5F142/CA13 5F142/CB14 5F142/CD15 5F142/CD16 5F142/CD17 5F142/CD23 5F142/CD25 5F142/CD44 5F142/CD47 5F142/FA32 5F142/FA40 5F142/FA50 5F142/GA01 5F142/GA40		
其他公开文献	JP6533838B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

公开了一种微型发光二极管的方法，制造方法，设备和电子设备。输送微型发光二极管的方法包括以下步骤：在具有激光透射性质的原始基板的背面上形成掩模层作为其表面上具有微型发光二极管的原始基板，接收微型发光二极管并与预先安装在基板上的连接焊盘接触通过掩模层从原始基板侧照射激光，从原始基板剥离微型发光二极管。

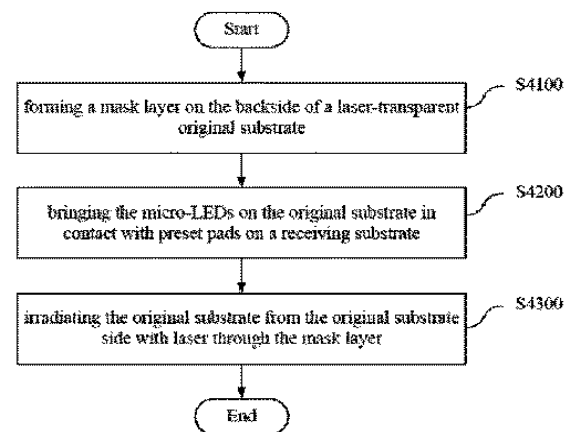


FIG. 19